

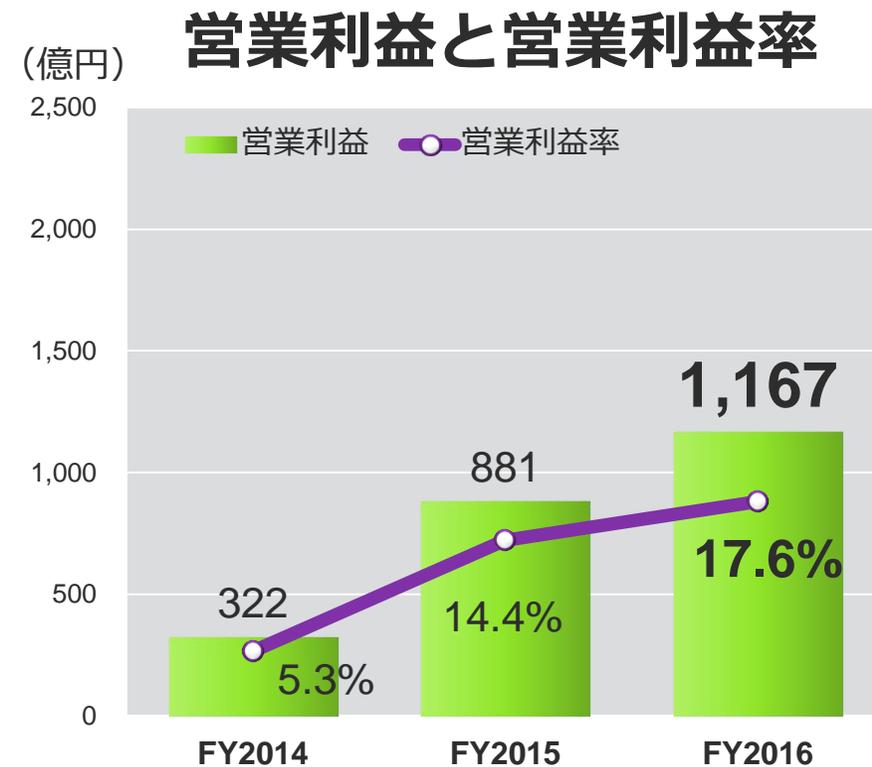
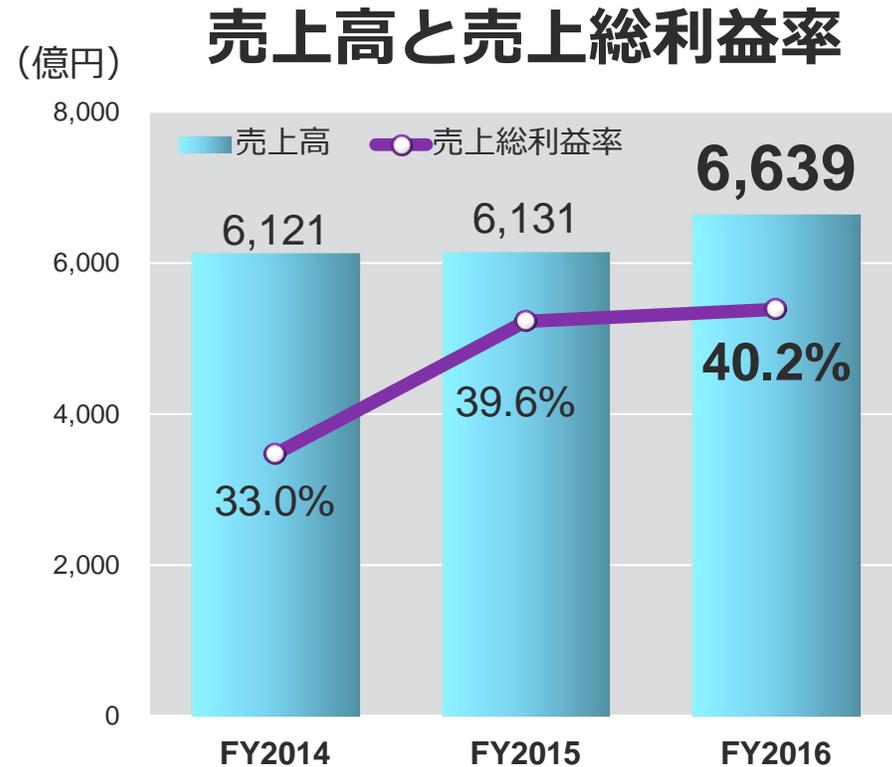
中期経営計画の進捗と当社の取り組み

2016年7月7日

河合 利樹
代表取締役社長、CEO



2016年3月期 ハイライト



- 前期から増収増益 売上高 6,639億円、過去最高の売上総利益率 40.2%
- 2008年の世界金融危機後、初の1,000億円超の営業利益を達成。営業利益率も大きく改善し、3.2pts増加の17.6%

2016年3月期 ハイライト

- 2008年の世界金融危機後、初の1,000億円超の営業利益を達成
- 前期比+8.3%の増収、売上総利益率 40.2%、営業利益率 17.6%、ROE 13.0%を達成。中期事業目標に向け順調に進捗
- 中期計画に向けたSPEの注力分野（エッチング、洗浄、ALD装置）で、顧客における半導体製造プロセスへの装置採用認定が着実に進展
- メーカー機能 および 顧客対応力強化に向けた組織再編を実施
- 新株主還元策を公表、1,540万株の自己株式の消却、過去最高の237円の配当を実施
- 中期計画との連動性を重視した攻めのガバナンスを構築、発表

2017年3月期 連結業績見通し

		上期	下期	通期	前期比
売上高		3,300	3,840	7,140	+7.5%
部門別 売上	SPE	3,040	3,610	6,650	+8.5%
	FPD	260	230	490	+9.7%
営業利益		490	750	1,240	+6.2%
		14.8%	19.5%	17.4%	-0.2pts
経常利益		490	750	1,240	+3.9%
税引前利益		390	750	1,140	+7.1%
親会社株主に帰属する当期純利益		290	560	850	+9.1%

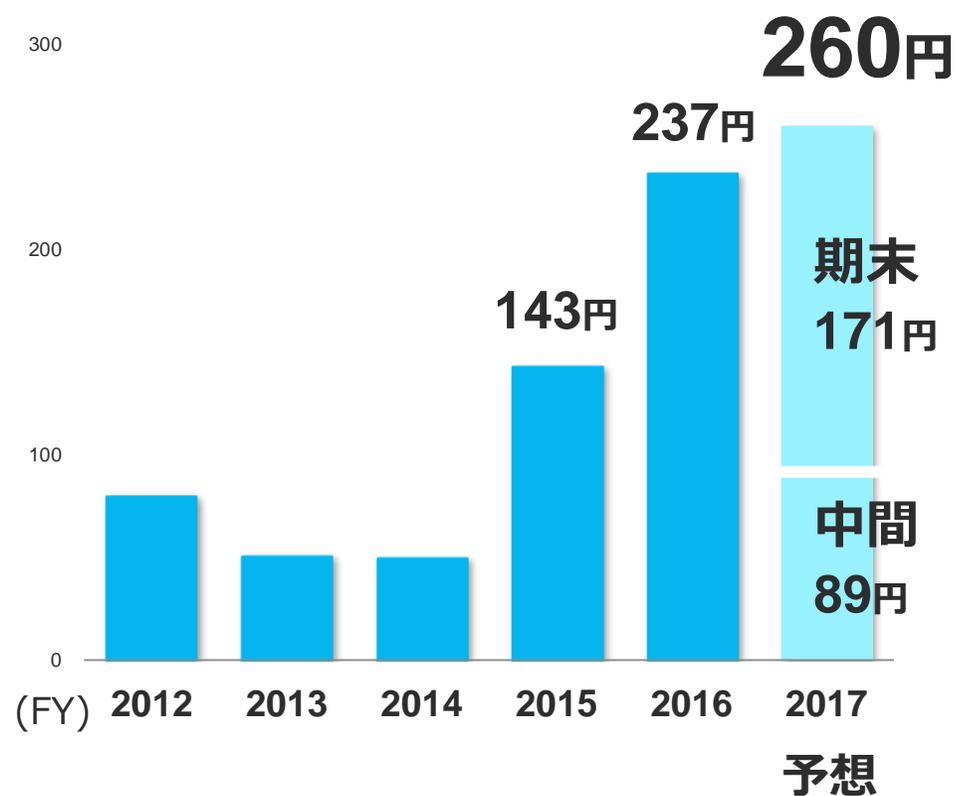
(億円)

SPE : 半導体製造装置 FPD : フラットパネルディスプレイ

前期に対し、さらなる増収増益を見込む

配当金予想

1株当たり配当金



- 2017年3月期配当予想は260円
- 3期連続で過去最高を更新予定

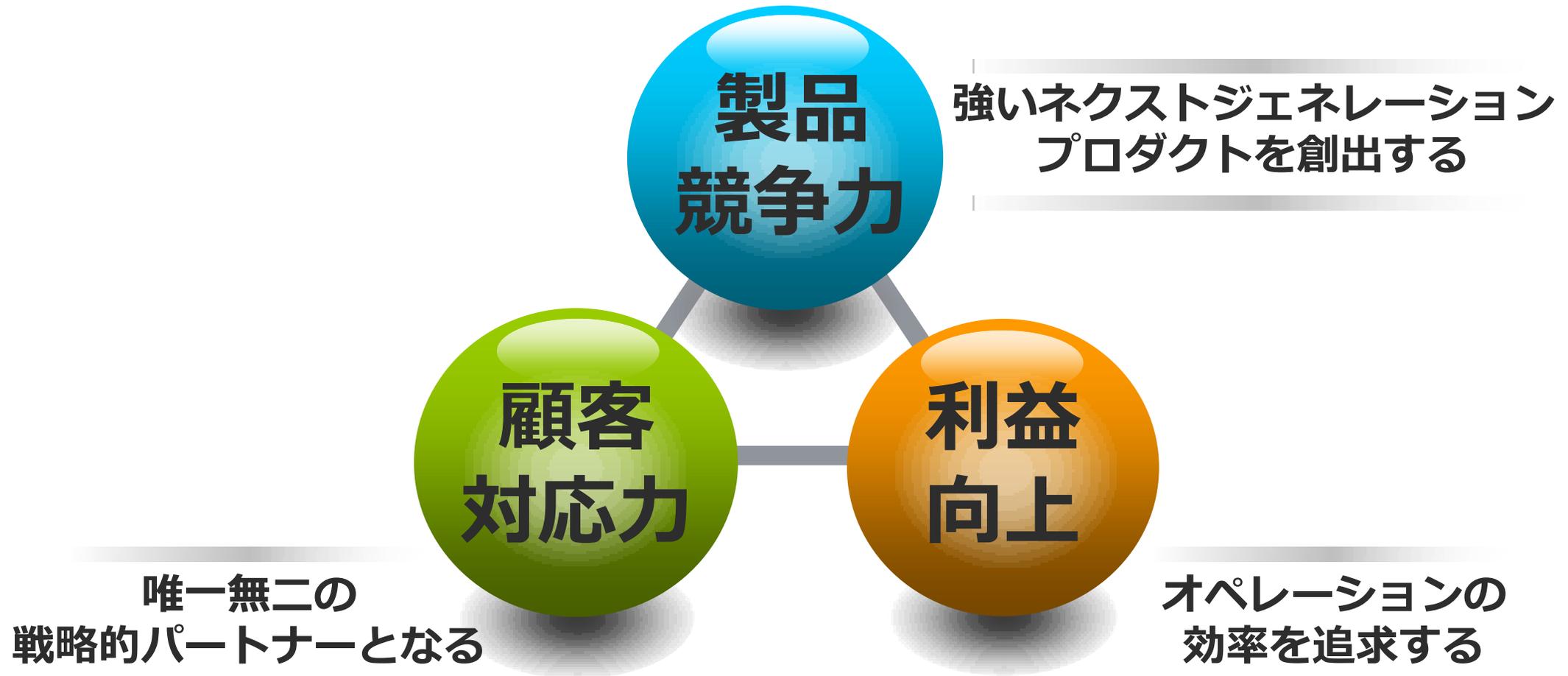
中期事業目標 進捗

半導体前工程製造装置 市場規模	FY2015実績 319億ドル	FY2016実績 315億ドル
売上	6,131億円	6,639億円
営業利益率	14.4%	17.6%
ROE	11.8%	13.0%

中期事業目標

300億ドル	370億ドル
7,200億円	9,000億円
20%	25%
15%	20%

新しい成長に向けた3つの強化項目



強化に向けた組織改革

- 1 開発部門の一元化** 2016年1月実施済み
- 2 顧客別新体制の導入** 2016年1月実施済み
- 3 ビジネスユニットの再編** 2016年7月より開始

最適組織でさらなる成長を目指す

開発部門の一元化 強いNext Generation Productの創出

- **市場目線で技術提案力を強化**
- **当社が保有する多様な技術の融合**
 - 単一装置性能の向上
 - パターニングやインテグレーションに対する提案
- **リソースの最適化**

顧客別新体制の導入

背景

- 海外売上比率80%、半導体メーカーの再編

- 技術の多様化

単一装置の性能向上に加え、デバイスの製造手法・工程の最適化へ

アクション

- 顧客ごとに営業・開発責任者を任命

- 顧客ニーズ創造型の技術マーケティングを追求

目的

- お客さまのニーズを迅速に拾い、期待以上のものを提案

- これまで培ってきた絶対的信頼に磨きをかけ、唯一無二の戦略的パートナーへ

ビジネスユニットの再編

- **4つの戦略市場に合わせ、ビジネスユニットを再編
(成膜、塗布・洗浄、エッチング、テストシステム)**
 - 各戦略市場の目線で、最大の技術シナジー生む体制を構築
 - リソースの有効活用
 - 意思決定の更なる迅速化

当社の半導体製造装置



コータデベロッパ
CLEAN TRACK™
LITHIUS Pro™ Z



枚葉洗浄装置
CELLESTA™-i



プラズマエッチング装置
Tactras™ Vigus™



熱処理成膜装置
TELINDY PLUS™



ALD成膜装置
NT333™



枚葉成膜装置
Triase+™EX-II™ TiN



マルチセル
テストシステム
Cellcia™

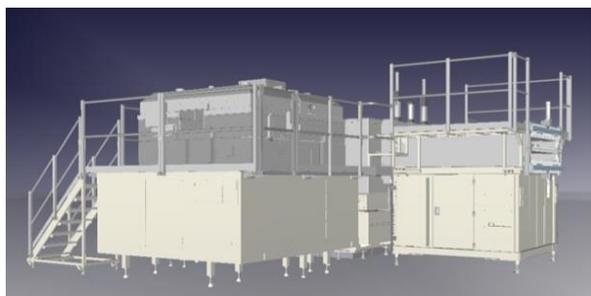
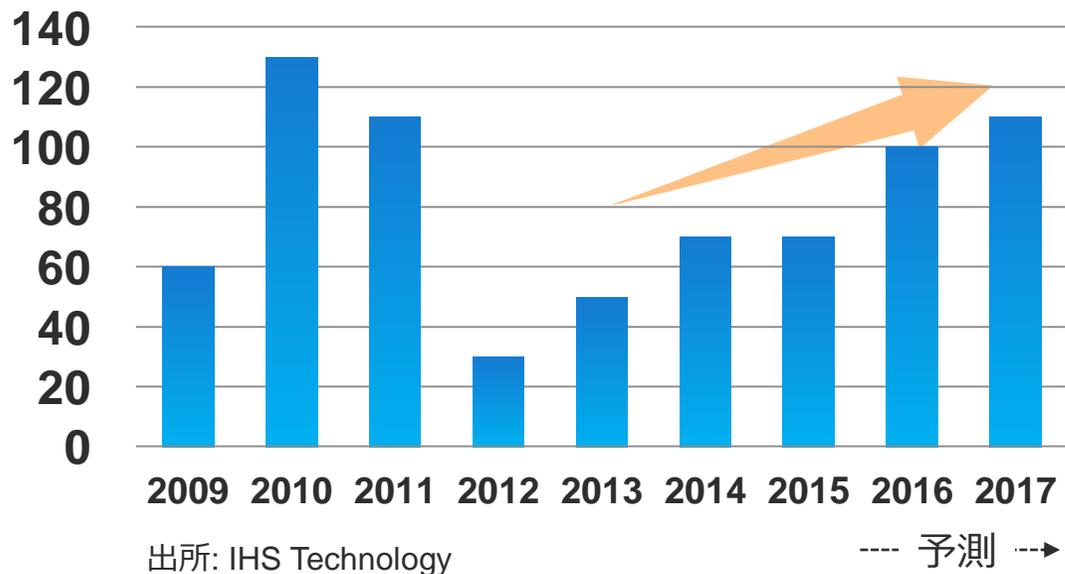
TOKYO ELECTRON

高度な技術課題を解決する多彩な製品群

再び1兆円に向かうFPD製造装置市場

FPD製造装置市場

(億ドル)



FPDプラズマエッチング/アッシング装置

Impressio™ 1800 PICP™



有機ELパネル製造用インクジェット描画装置

Elius™ 2500

急成長する有機ELディスプレイ装置市場に新製品を投入

サマリー

■ 開発部門の一元化

- 強いNext Generation Productを創出
- 豊富な製品ラインナップを活かし、多様なニーズへ対応

■ 顧客別新体制の導入

- お客さまからの絶対的な信頼に磨きをかけ、唯一無二の戦略的パートナーへ

■ ビジネスユニットの再編

- 4つの戦略市場に注力、最大の技術シナジーを生む体制を構築

■ フィールドソリューション事業での収益を拡大

■ FPD製造装置事業：付加価値エリアへの対応を通じ更なる成長を目指す

- 超高精細、低消費電力、大型化

SPE開発戦略

佐々木 貞夫

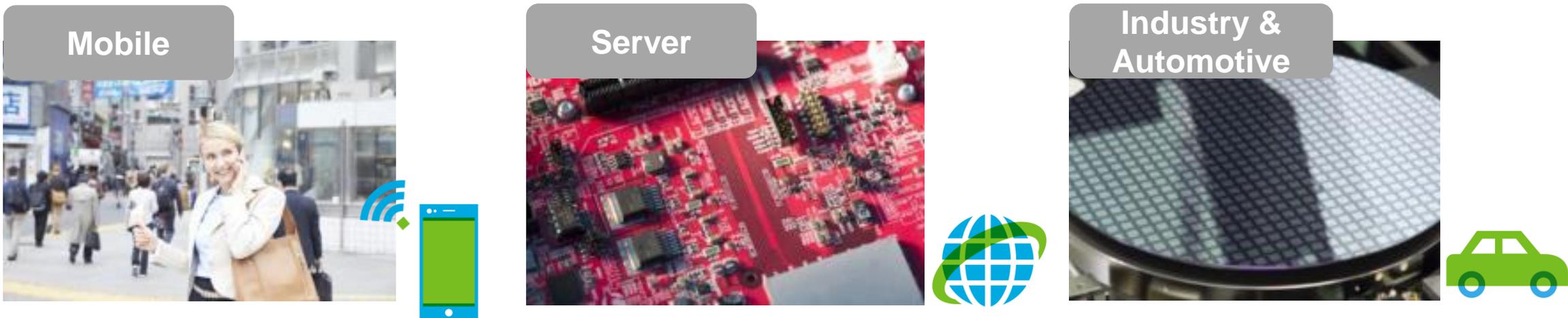
代表取締役、専務執行役員、開発・生産本部長



内容

- 先端技術への要求と当社の事業機会
 - 最終製品の動向から見る 次世代先端デバイスへの技術要求
 - SPE事業の重点課題
- SPE開発戦略
 - 開発力の強化戦略
 - 重点事業分野（成膜、洗浄装置）における成長戦略
 - IoT技術開発

最終製品から見た次世代デバイスへの要求



利便性・ユーザー体験の追求

IoT時代に向けた用途の広がり

社会全体のデジタルデータ化
高度なネットワーク化

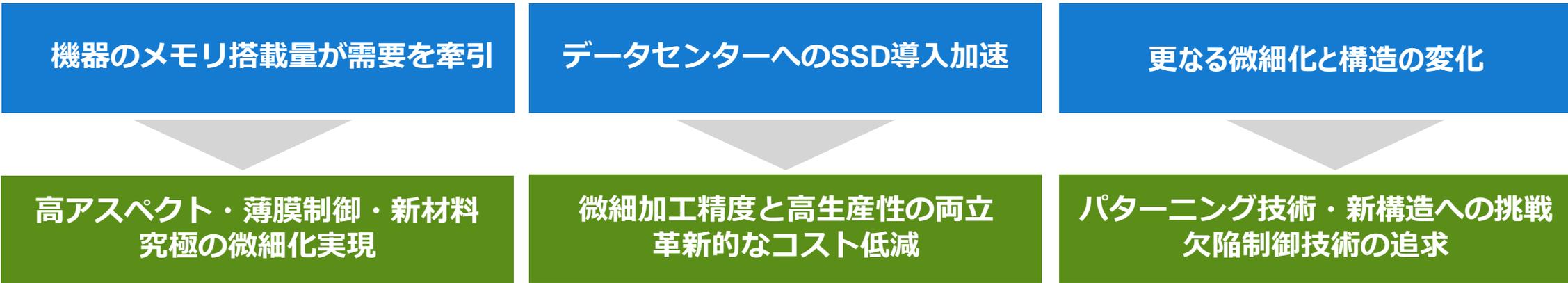
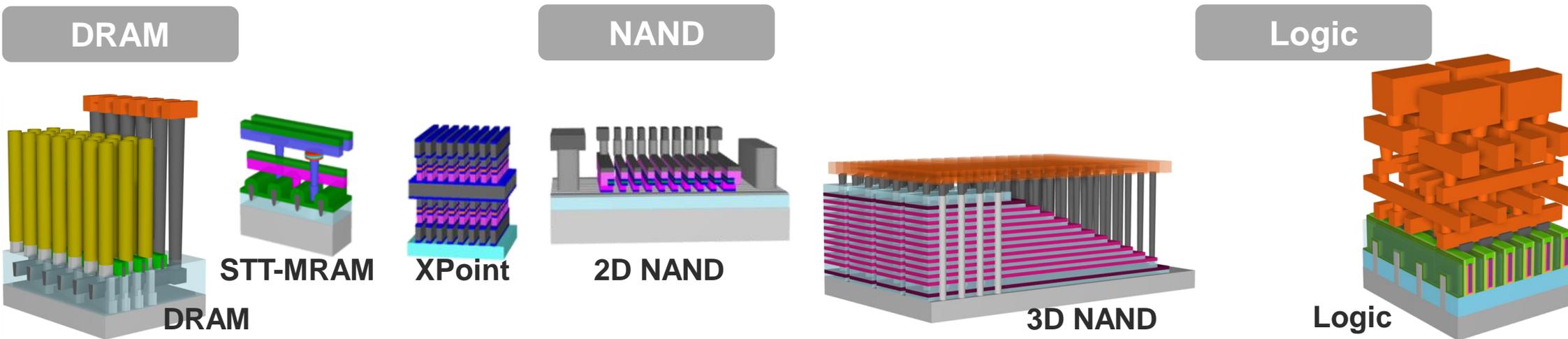
高パフォーマンス・低電力要求
機能の複合化

加速する3D高集積化
次世代メモリ技術の導入

低消費電力・高信頼デバイス

継続する微細化要求、高品質・高信頼性デバイスの要求

半導体デバイスから見た半導体製造装置への要求



顧客ニーズ把握と、装置・プロセスソリューションの早期提供

SPE事業の重点課題



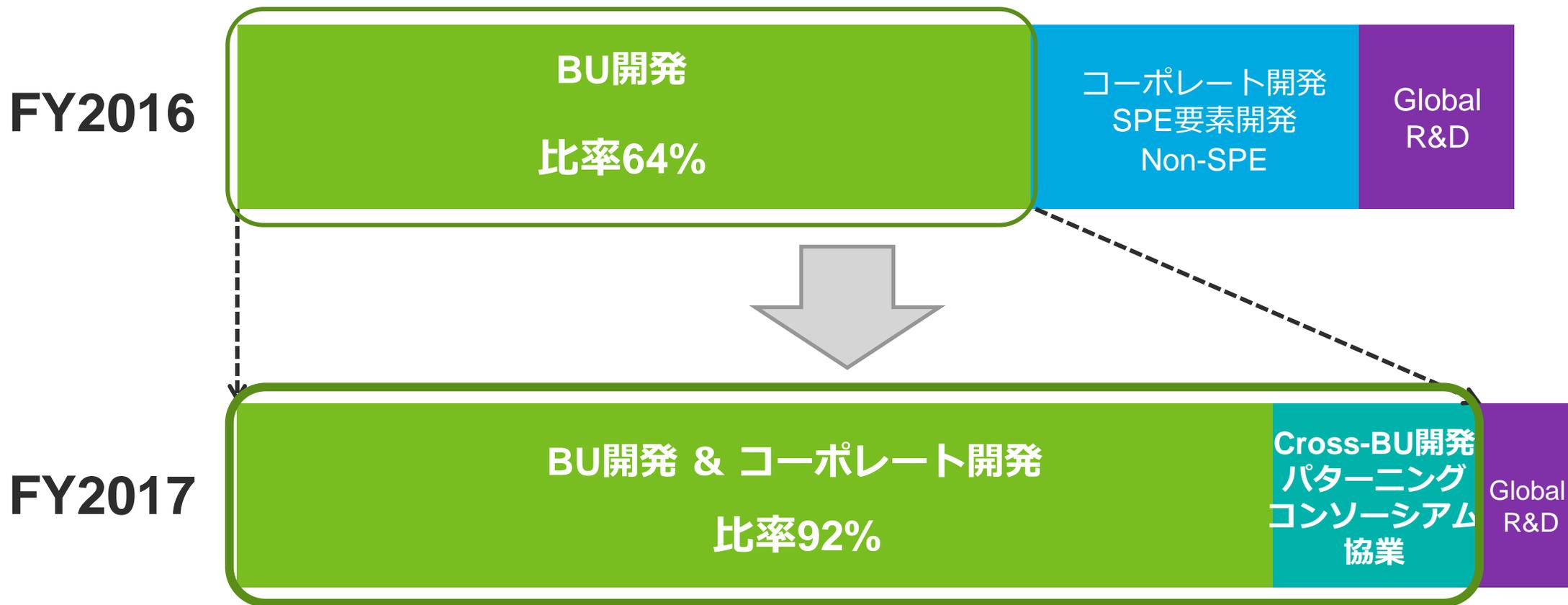
- コータ/デベロッパ** 市場シェア85%以上を維持。先端液浸・EUVにおいて更なる技術差別化
- エッチング装置** 3D NANDの採用工程拡大、新技術によるパターンニング工程のPOR拡大
- 成膜装置** ALD製品のポジション向上と新製品による市場拡大、STT-MRAM*の量産確立
- 洗浄装置** 3D NANDバッチ装置拡販と、パターン倒壊抑制技術による枚葉シェア向上
- 共通技術** 微小欠陥制御・除去技術、装置のインテリジェンス化

*STT-MRAM (Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory) : 低消費電力が期待できる磁気メモリ
 CORP IR / July 7, 2016

SPE開発戦略

開発リソースの一元化

- 半導体製造装置開発へ全社開発リソースを選択と集中



※開発エンジニア人員の配置比率

3D NANDのキープロセス技術と当社のソリューション

プラズマドライエッチ

- ・ ワードライン分離
- ・ チャンネルホール
- ・ 多段コンタクト



Tactras™

リソグラフィ

- ・ ワードライン分離
- ・ チャンネルホール
- ・ 多段コンタクト
- ・ コンタクトパッド

LITHIUS Pro™ Z



ケミカルドライエッチ

- ・ ソースライン向け前洗浄

Certas™



ワードライン

EXPEDIUS™-i



ウェットエッチ

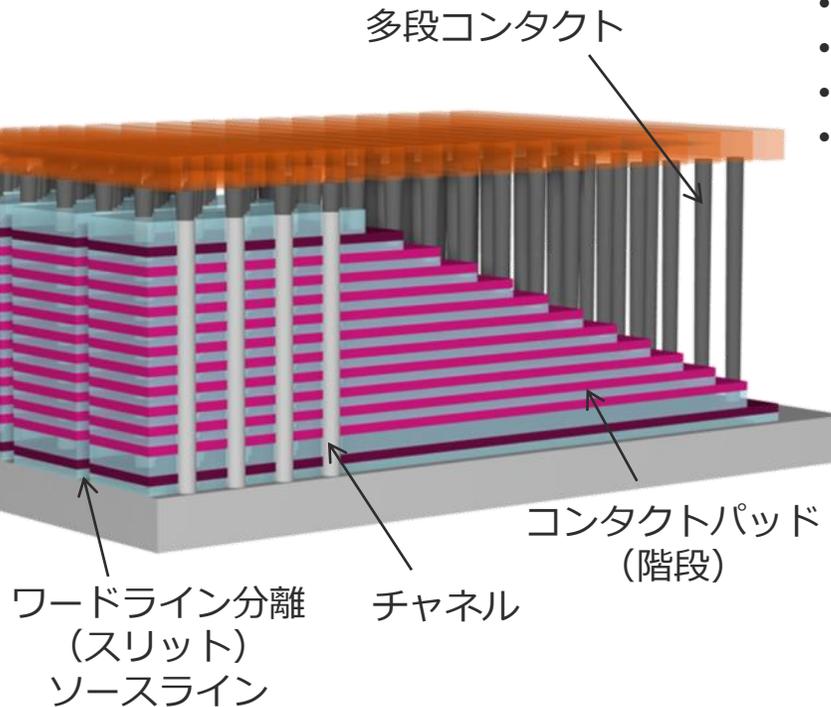
- ・ ダミーワードライン除去

CELLESTA™-i



ウェット洗浄

- ・ ベベル洗浄



熱プロセス (バッチ成膜)

- ・ ブロック酸化膜 (high-k)
- ・ チャージトラップ (ALD SiN)
- ・ チャンネルシリコン
- ・ キャップシリコン

TELINDY PLUS™



ALD成膜

- ・ コア酸化膜

枚葉成膜

- ・ ワードラインバリア
- ・ 多段コンタクトバリア
- ・ ソースラインバリア

Triase+™



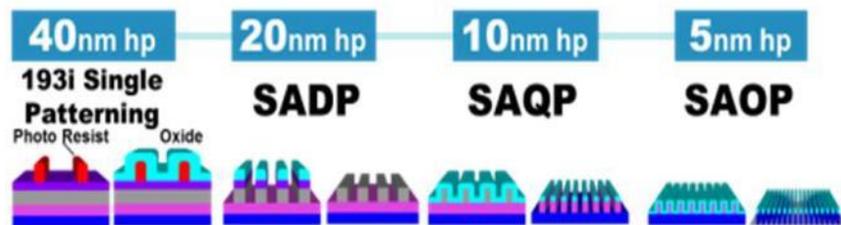
NT333™



SPE事業戦略：パターニングにおける戦略的協業

顧客協業

幅広い製品群を活かしたインテグレーション・ソリューションの提案と共同評価を通じ次世代POR獲得へ



コータ/デベロッパ



ケミカルエッチング装置



エッチング装置



洗浄装置



成膜装置

コンソーシアム



COLLEGES OF NANOSCALE SCIENCE + ENGINEERING
SUNY POLYTECHNIC INSTITUTE



Institute of Microelectronics

A*STAR

新技術

新材料

最先端リソグラフィー

+

自社開発拠点

パターニングソリューションプロジェクト

TEL Technology Center America

SPE開発戦略（成膜・洗浄）

SPE事業戦略：成膜装置ラインナップ拡充

熱処理成膜装置
TELINDY PLUS™



枚葉成膜装置
Triase+™



ALD 成膜装置
NT333™



枚葉成膜装置
Triase+™



次世代半導体向け成膜装置
EXIM™



CVD

ALD

PVD

ラージバッチ式
多種成膜対応

枚葉式
高カバレッジ性能

セミバッチ式
高生産性SiO₂ ALD

枚葉式
高精度メタル成膜

枚葉式
多層・積層膜対応 新PVD
電子デバイス産業新聞主催
半導体・オブ・ザ・イヤー2015受賞

微細化、3D化に求められる高カバレッジ、高生産性ニーズに対応する装置群

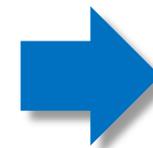
SPE事業戦略：洗浄装置

- 当社の強みである枚葉ウェット装置で歩留まり向上に寄与
 - パターン倒壊抑制技術
 - 配線工程ポリマー除去/メタルロス低減
 - 高精度裏面ベベル洗浄
- ドライ洗浄で高度な技術ニーズに対応
- さらなる微細化に対応した新技術導入を加速しシェア向上を目指す
 - 裏面ベベル洗浄の強化技術
 - 微小パーティクル制御/除去



枚葉洗浄装置
CELLESTA™

市場シェア	CY2014	CY2015
洗浄装置	25%	24%



CY2019目標
>35%

IoT開発戦略（装置インテリジェンス化）

新たな付加価値の提供

IoTによるビッグデータとAIの活用

IoTを活用して多種多様なデータを解析し

エキスパートのナレッジと併せて

自らが最適に安全に制御しながら学習する

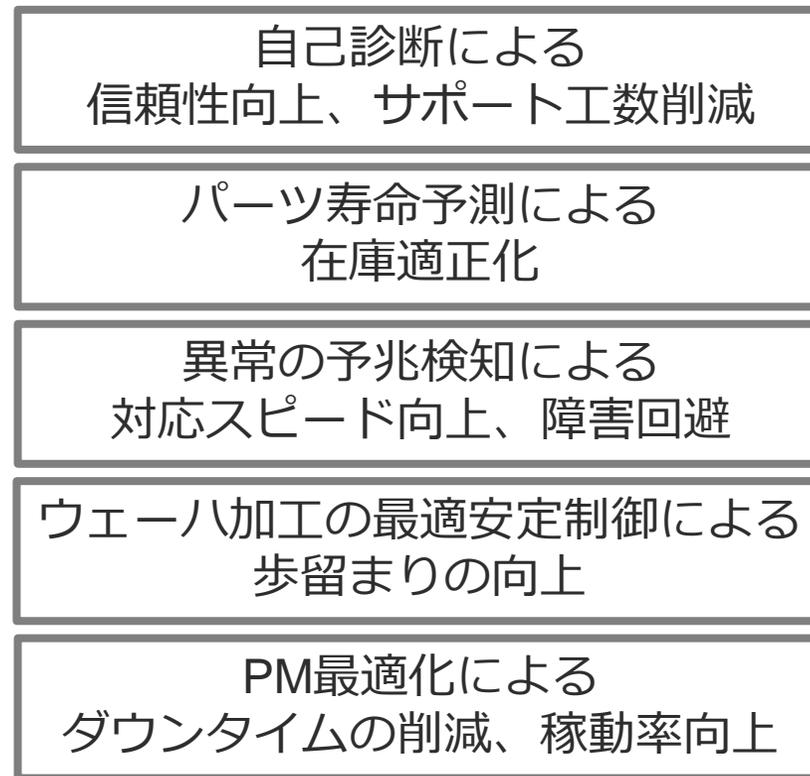
インテリジェントな装置を開発



開発の取り組み

装置の最適安定制御

ビジネス的価値



最新のテクノロジーを取り入れて高効率化を実現、持続的な高収益体質を築く

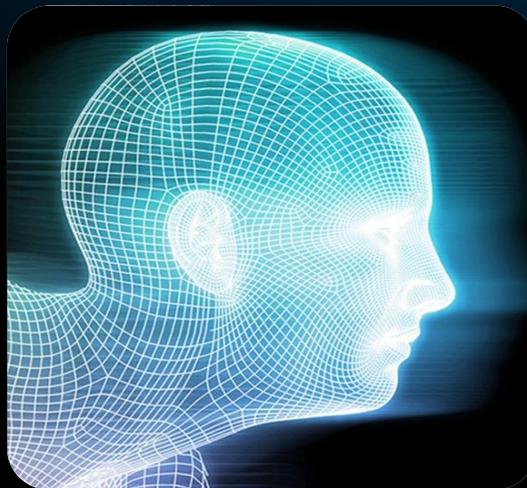
半導体製造装置のインテリジェンス化

自己診断機能



最適装置管理

学習機能



絶対的安定稼動

自律制御機能



性能最大化

自律型生産システムの開発

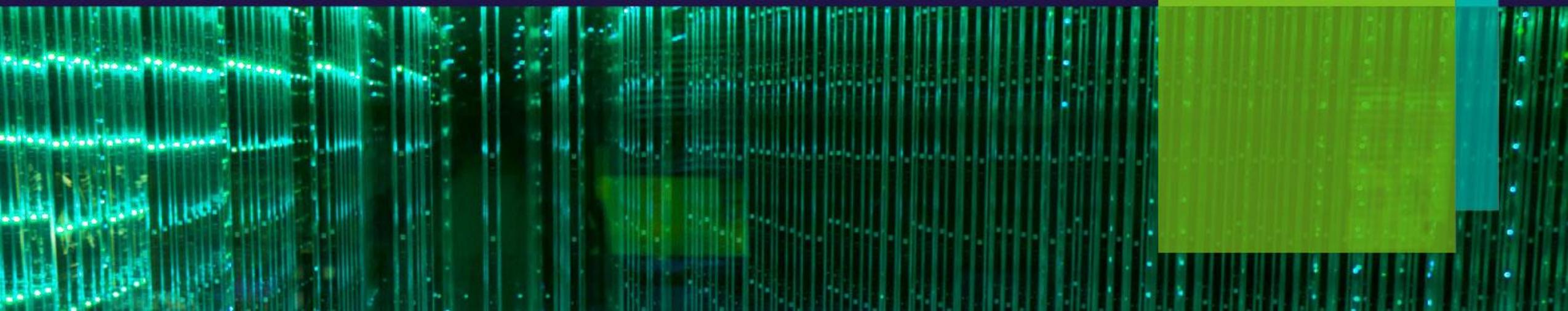
サマリー

- **最終製品からのニーズを受けて、半導体製造装置への革新的技術の要求が益々高まり、当社は将来に向けて大きく成長する**
- **革新的技術の創出のため、顧客とコンソーシアムとの協業を戦略的に強化し、既存のプロダクト別事業の成長と、クロスBUのシナジー効果による成長を目指す**
 - **パターニングソリューションの技術開発の推進**
 - **半導体製造装置のインテリジェンス化**
- **開発リソースの一元化で、エッチング、成膜、洗浄のシェア向上を目指す**

先端半導体産業を取り巻く環境：パターンニング戦略

関口 章久, Ph.D.

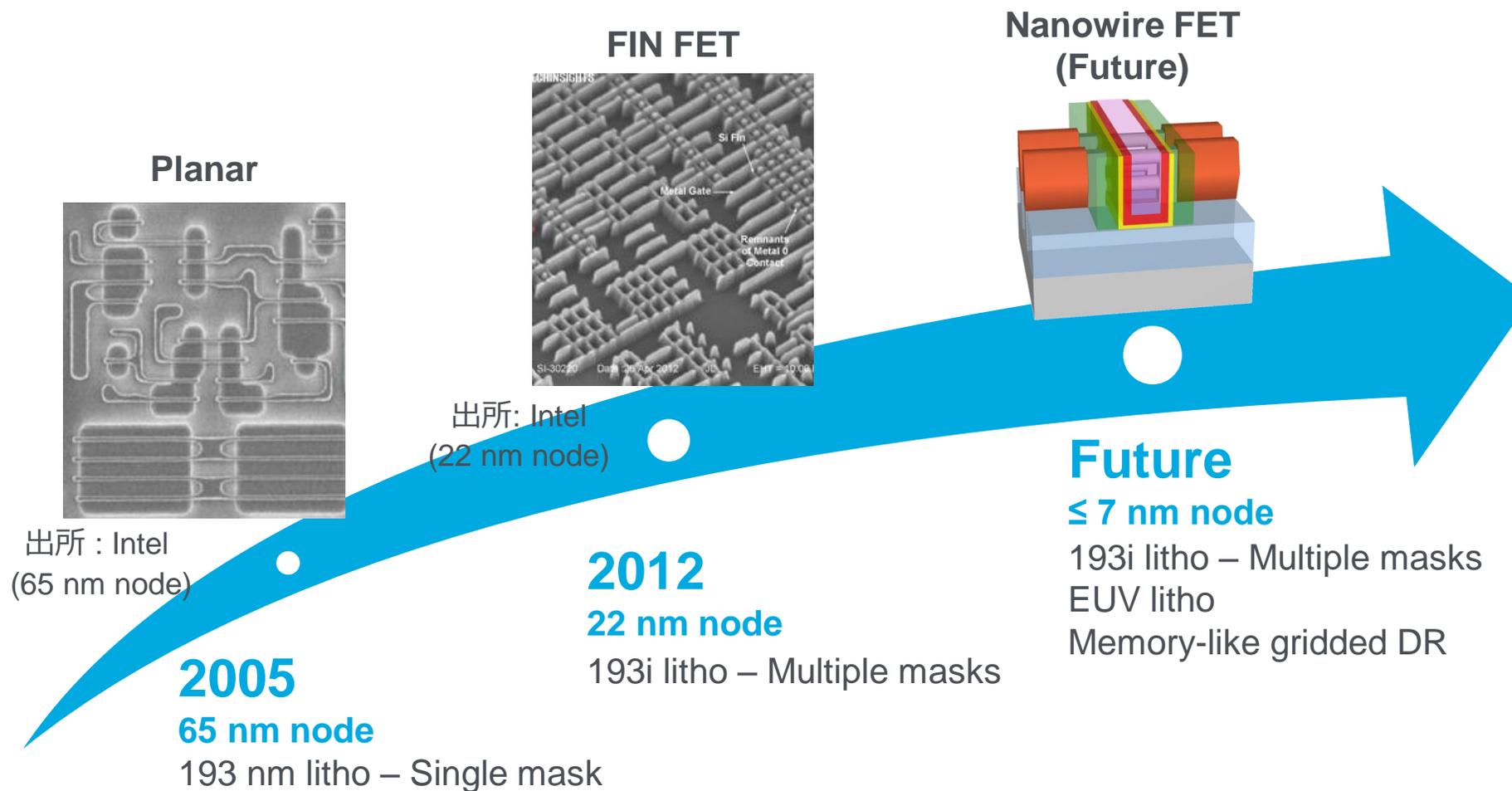
執行役員 先端半導体技術部門担当



内容

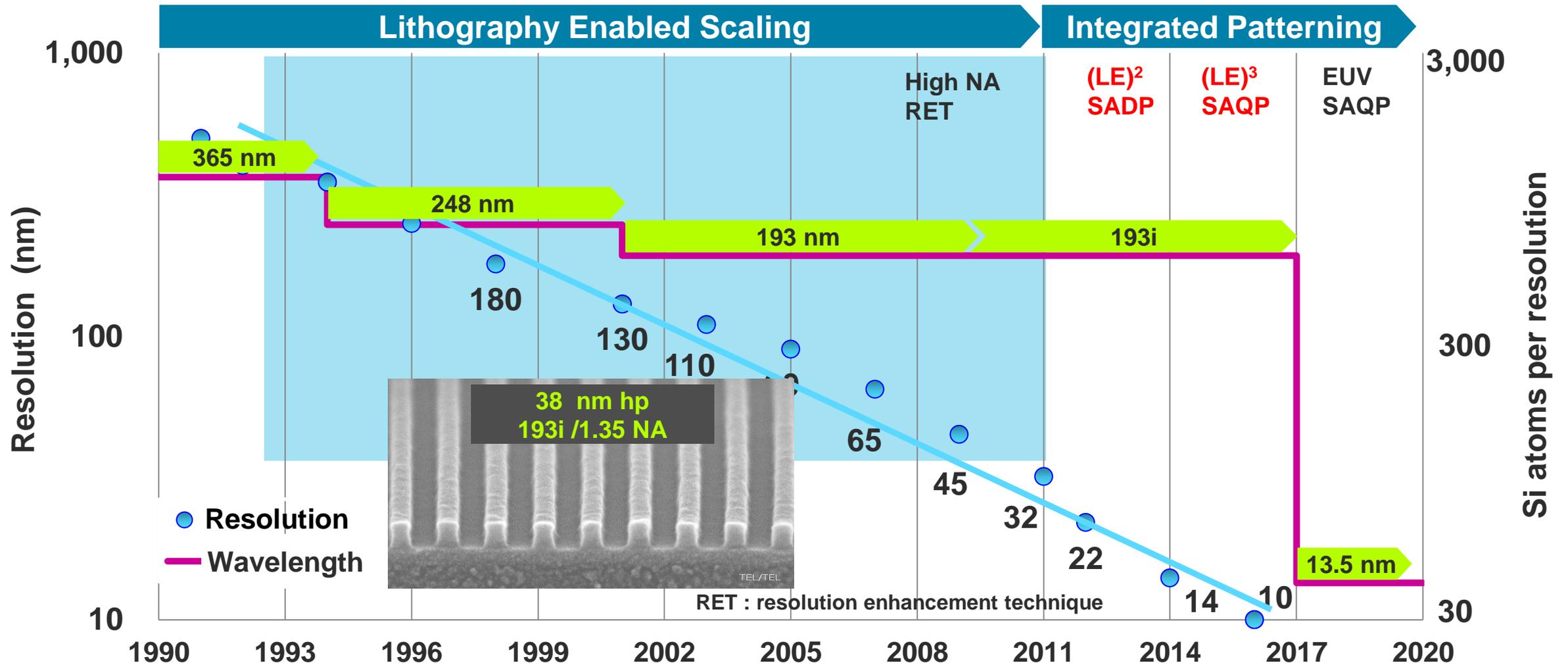
- パターニング技術課題点
 - 高度微細化の継続、デバイス構造3次元化
 - ArF露光の限界とEPE（Edge Placement Error）
- 技術アプローチ
 - ユニットプロセス主体の開発
 - 統合型パターニングソリューション（複数装置を跨ぐソリューション）
- 次世代プロセス
 - 原子レベル制御、ALD（Atomic Layer Deposition）およびALE（Atomic Layer Etch）

先端半導体産業を取り巻く環境：半導体デバイスの3次元化



微細化と同時に半導体デバイス構造の3次元化が進んでいる、難度は上がっているがムーアの法則健在

先端半導体産業を取り巻く環境：液浸露光からEUVへ

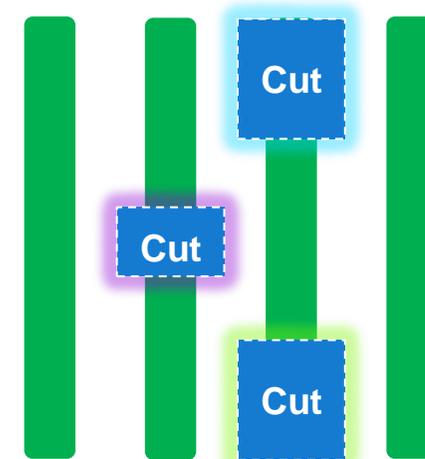
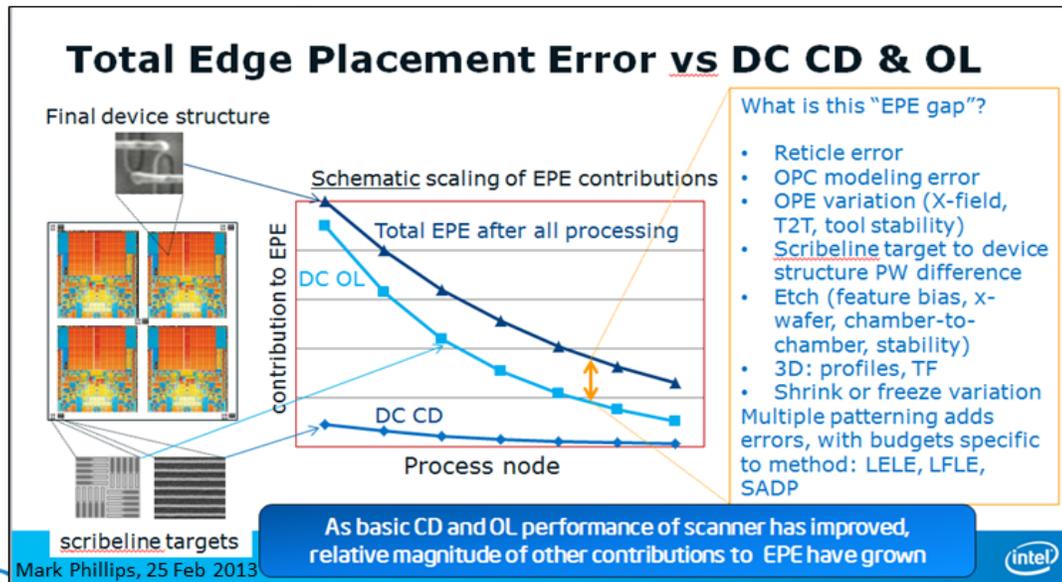


液浸ArF露光の限界もあり、すでに通常パターニングからIntegrated Patterningへ移行済み

技術課題：解像度および位置精度

3. Resolution isn't the only challenge

- Total Edge Placement Error is the biggest technical challenge to scaling (limiting before device physics)
 - Must reduce EPE contributions from all process steps (not just Litho) in order to take full advantage of resolution benefits of EUVL



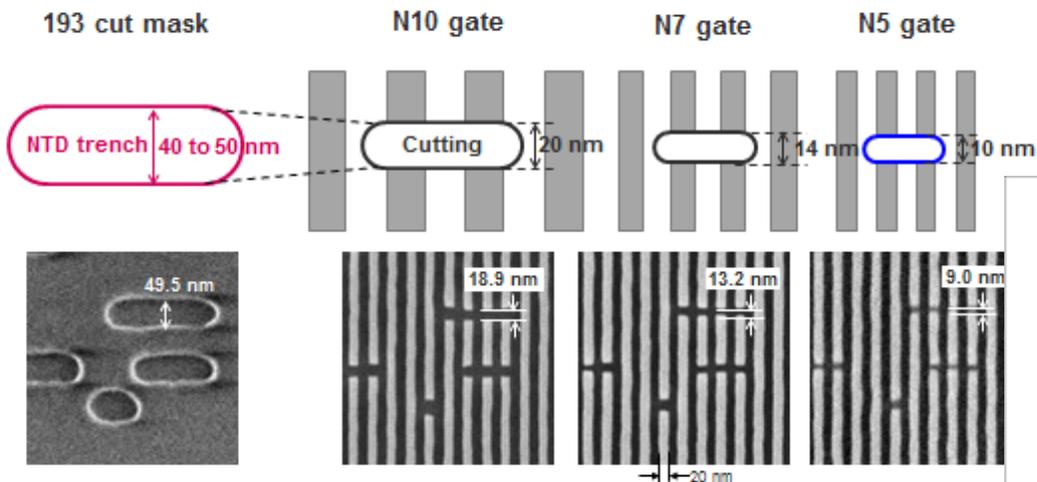
EPE (edge placement error)

LithoVision | 2016 出所：Intel

解像度だけではなく位置正確度もナノメートル単位で求められる

既存プロセスの進化：カット精度、シュリンク精度向上

Integrated patterning challenges – CD tolerance

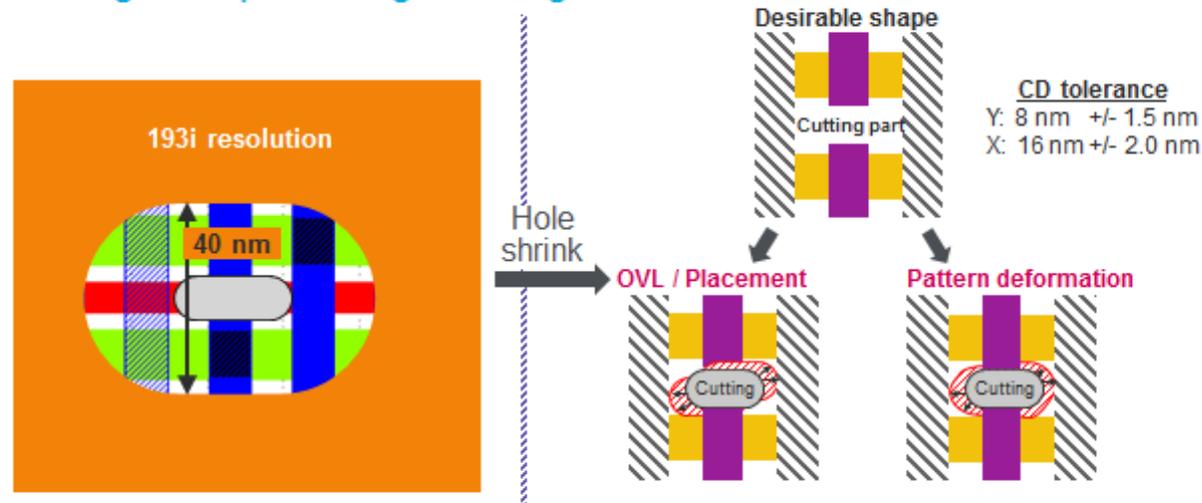


CD tolerance becomes smaller with scaling and process needs to evolve

Line Cut技術

Hole Shrink技術

Integrated patterning challenges – CD tolerance ホール



CD tolerance directly impacts line cut fidelity 現状シュリンク以外の手法が無い

TEL 7

エッチング・成膜関連技術の延命は必須

加工技術の更なる進化： 新たなインテグレーション・モジュール開発

SAMP

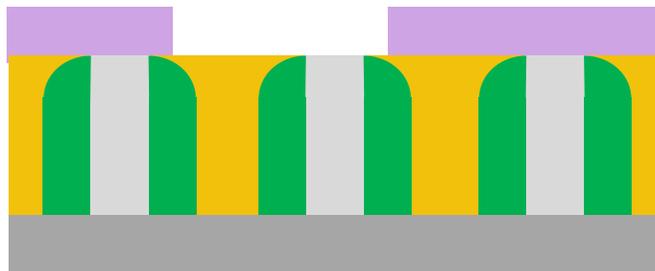
(self-aligned
multiple patterning)



SAMPにはALDによる
ナノメートル精度の
膜厚コントロールが必須

SAB

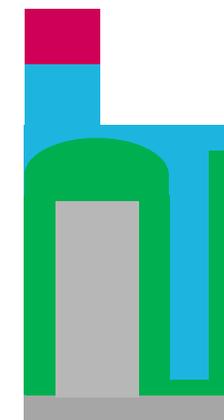
(self-aligned block)



SABは複数・複雑な素材を
組み合わせて初めて可能になる
(材料間エッチ選択比)

SAC

(self-aligned contact)



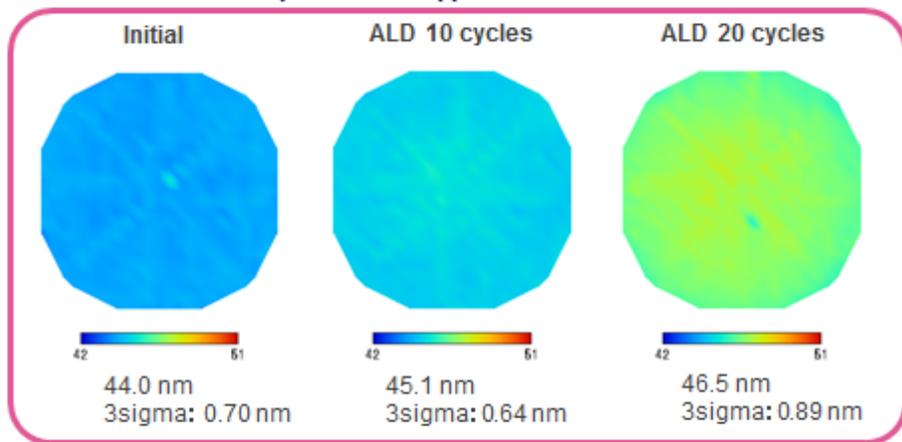
MOLで主流のSACには
ALDおよびALEが不可欠

様々な当社の装置・プロセスを組み合わせる創造的な提案

さらなるユニットプロセスの進化：原子レベル制御

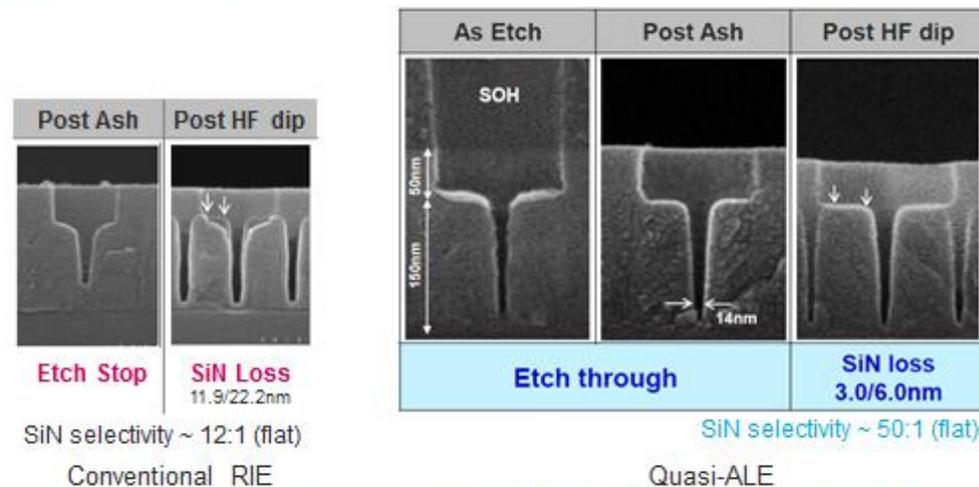
究極の成膜ユニプロ： Atomic Layer Deposition

The contour map shows the application of ALD on PR surface



It is possible to control the CD to 1 nm levels while keeping CDU 成膜はALDで確立済み

Application of quasi-ALE to SAC etch

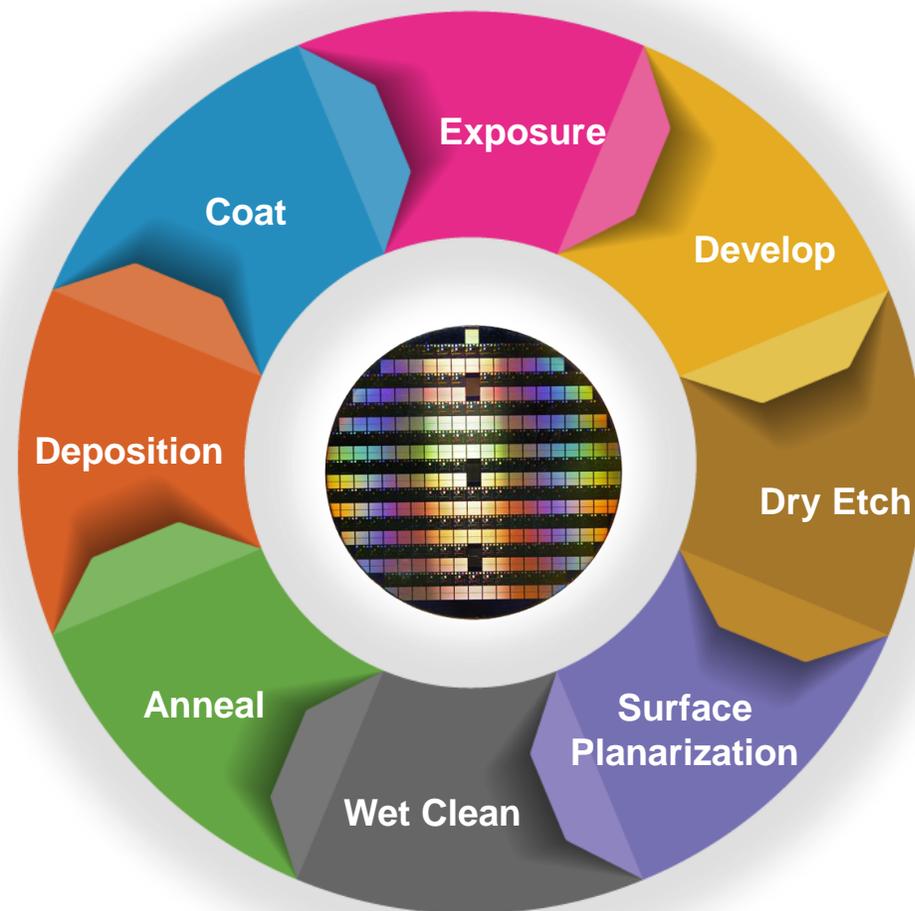


Quasi-ALE increases SiO2 etch selectivity to SiN without etch stop

ALDとALEは成膜とエッチング両方の知見がないと開発は不可

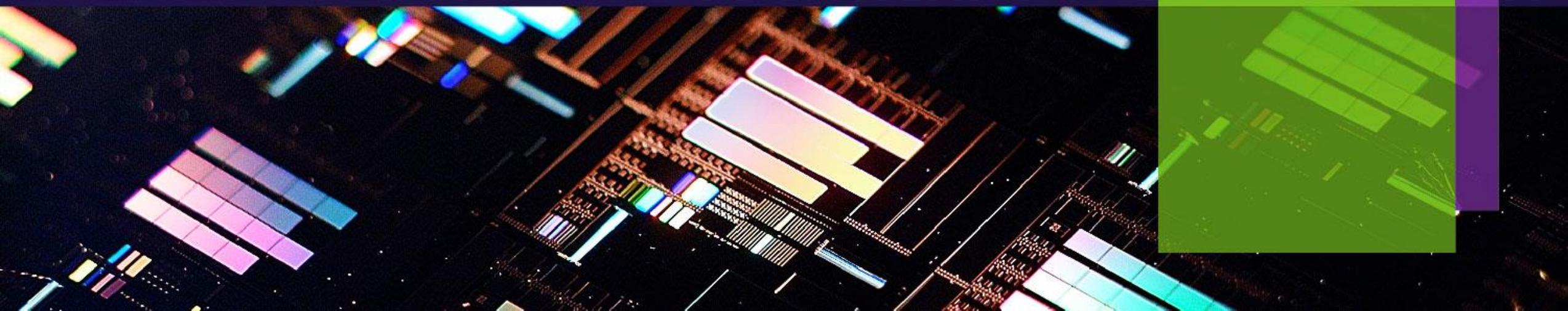
パターニング技術に関するサマリー

- ロジックでは引き続き微細化が重要
- プロセス技術難易度は高い
- 個々のプロセス向上と Integrated Solutionsが必須
- 当社の強みは成膜、エッチング、洗淨、塗布等あらゆるプロセス手法を有していること



エッチング装置 事業戦略

三田野 好伸
執行役員 ES BUGM



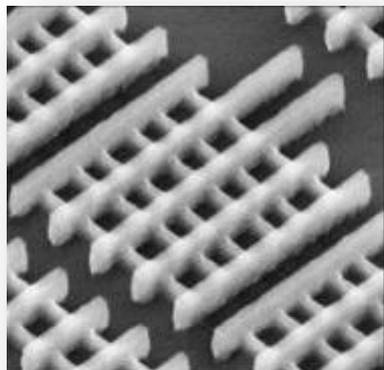
エッチング市場と当社の現況

- 3D NAND・パターンニング工程の増加により、エッチング市場の拡大が続く
- 3D NANDにおいて、今期は前期比2倍の売上を見込む
- 当社の技術優位性を活かし、中期計画初年度の進捗は順調

先端ロジックに求められるエッチング技術

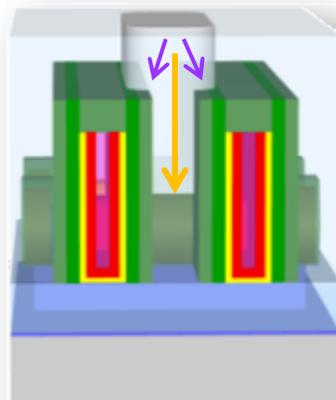
Demand for advanced Device

FIN FET (FEOL)



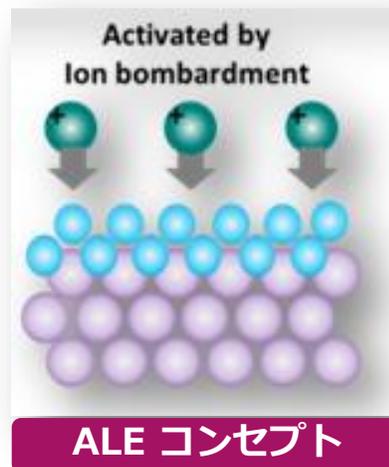
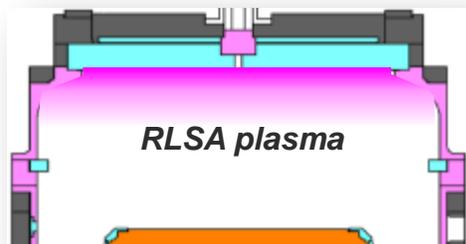
出所：Intel

SAC etch (MEOL)



- 低ダメージ/CD制御性
- 高選択比
- 垂直形状

Key Technology / Solution

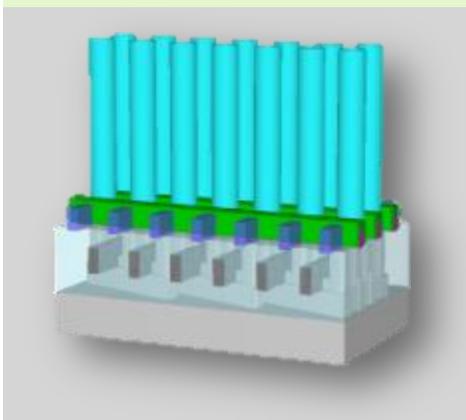


- 低電子温度
- ラジカル制御
- ALE技術

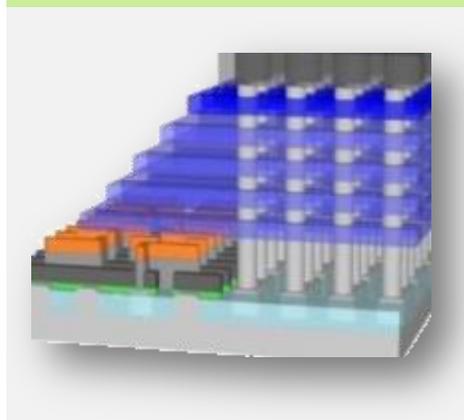
先端メモリに求められるエッチング技術

Demand for Advanced Device

DRAM

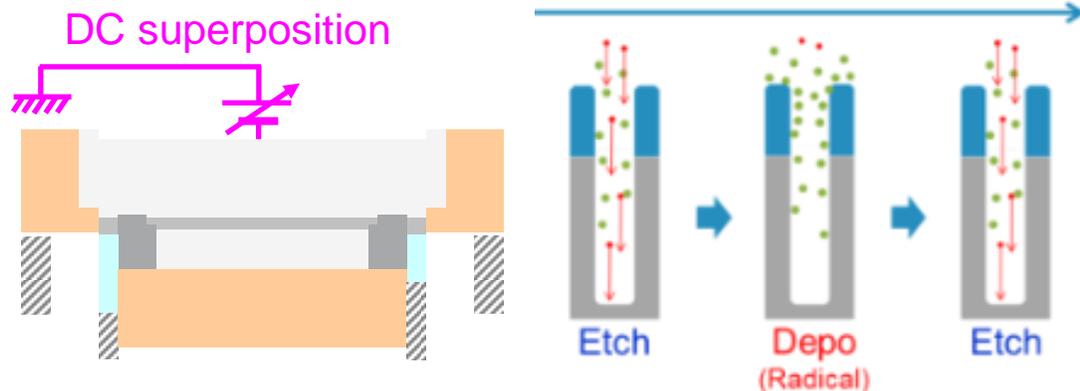


3D NAND



- 高マスク選択比
- 垂直エッチング形状
- 生産性

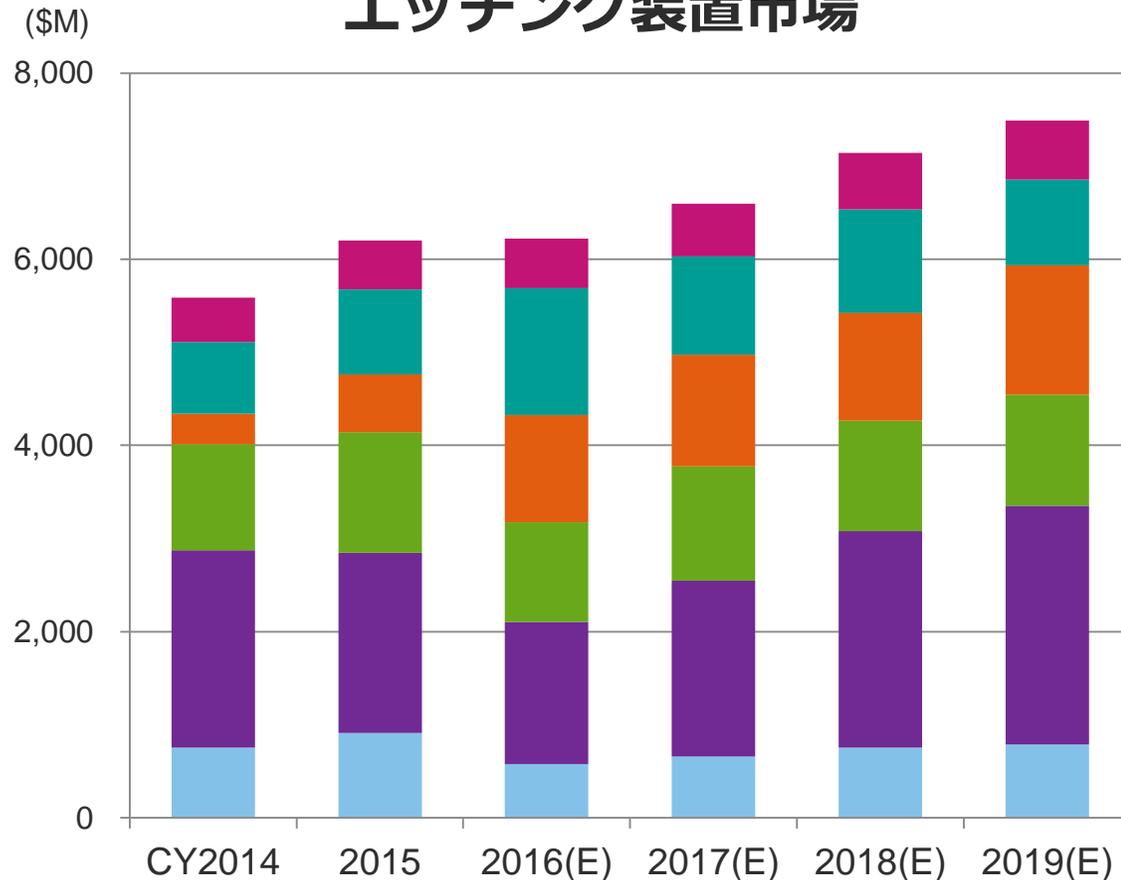
Key Technology/Solution



- 当社独自のDC印加技術
- “Dynamic” Process
- ウェーハ周辺のプロセス制御

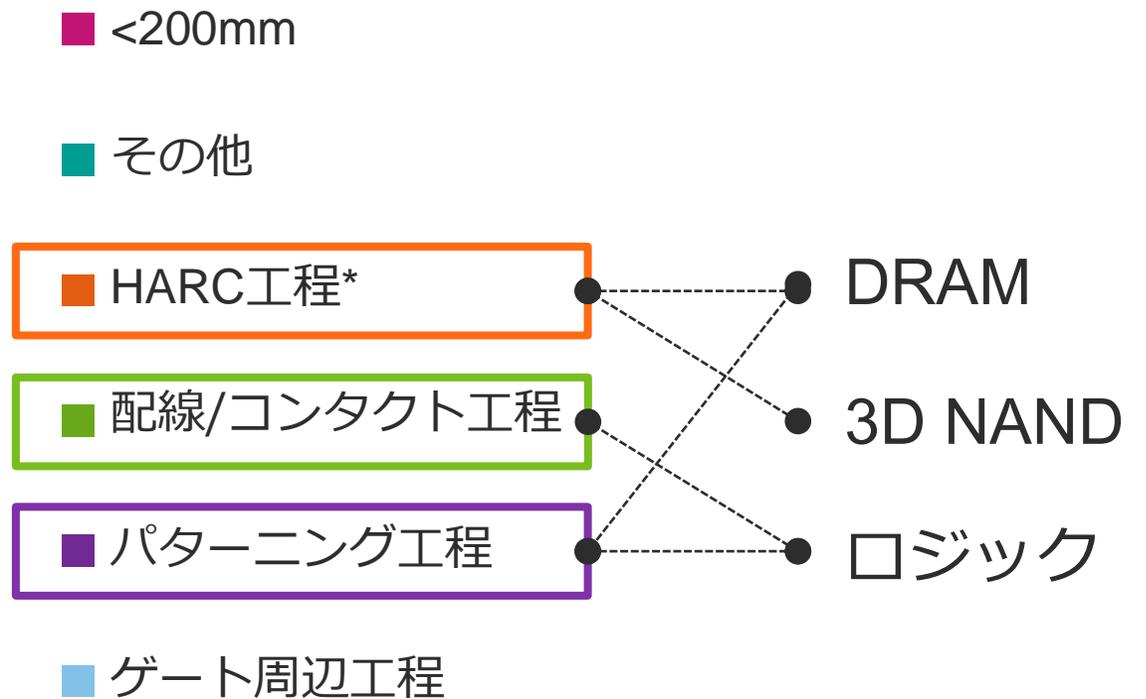
エッチング装置市場と事業機会

エッチング装置市場



Total Dry Etchのトータル市場規模：Gartner, "Forecast: Semiconductor Wafer-Level Manufacturing Equipment, Worldwide, 1Q16 Update" 14 April 2016
Sales Revenue based
ガートナーのリサーチを基に東京エレクトロンにて図表を作成
※アプリケーション別比率は当社による推定値

主要アプリケーションと対象デバイス

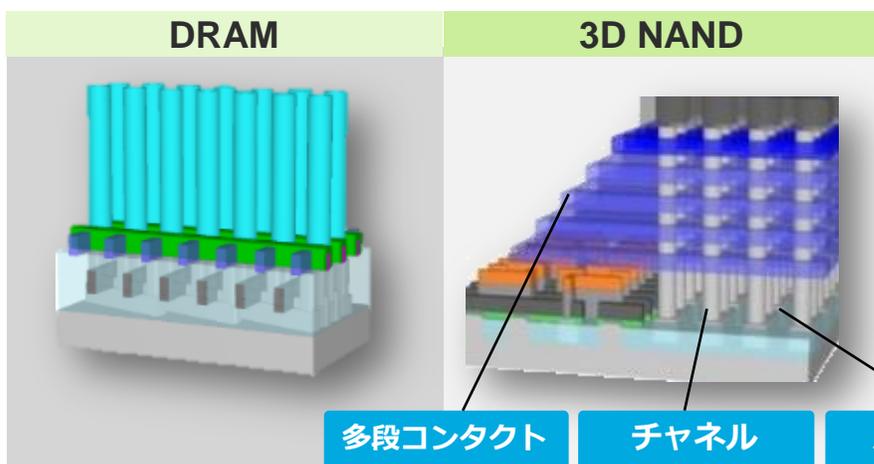


*HARC (High Aspect Ratio Contact) 工程：高度な加工技術を要する深穴形成工程

DRAM/3D NAND向けHARC工程

■ 市場ニーズ

- 微細化（DRAM）、積層化（3D NAND）で、一層の高アスペクト比の垂直加工が必要



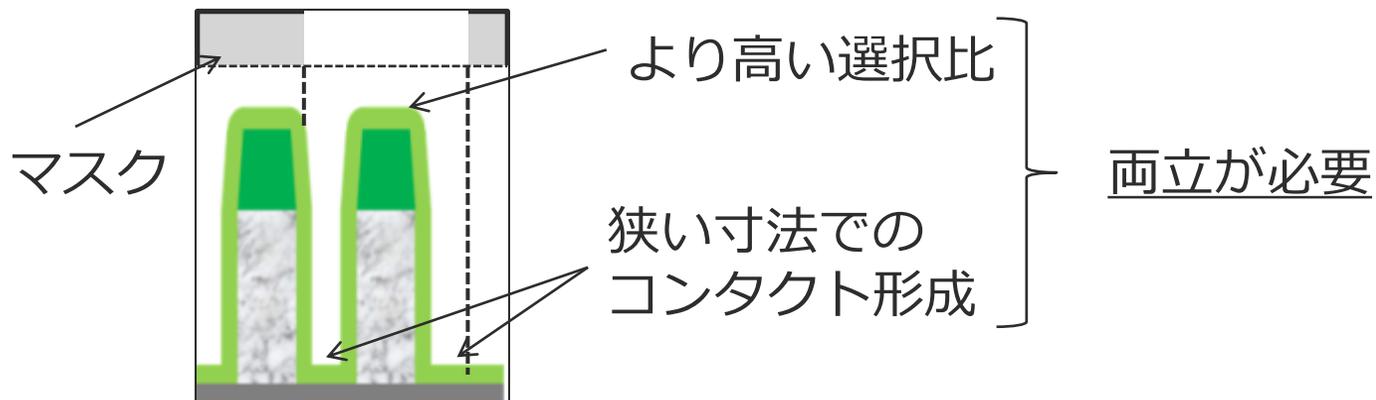
	CY2016	CY2017	CY2018	CY2019
DRAM	20~25nm	18~20nm	17~18nm	16~17nm
3D NAND	~48層	~64層	~96層	~128層

■ 当社の取り組みと成果

- DRAMの重要工程において、18nm以降の垂直加工を実現
- 3D NANDにおいて、多段コンタクト工程に加え、スリット工程の採用も進む
- ウェーハ周辺部のプロセス性能向上による生産性向上（チップ数増加）

配線/コンタクト工程

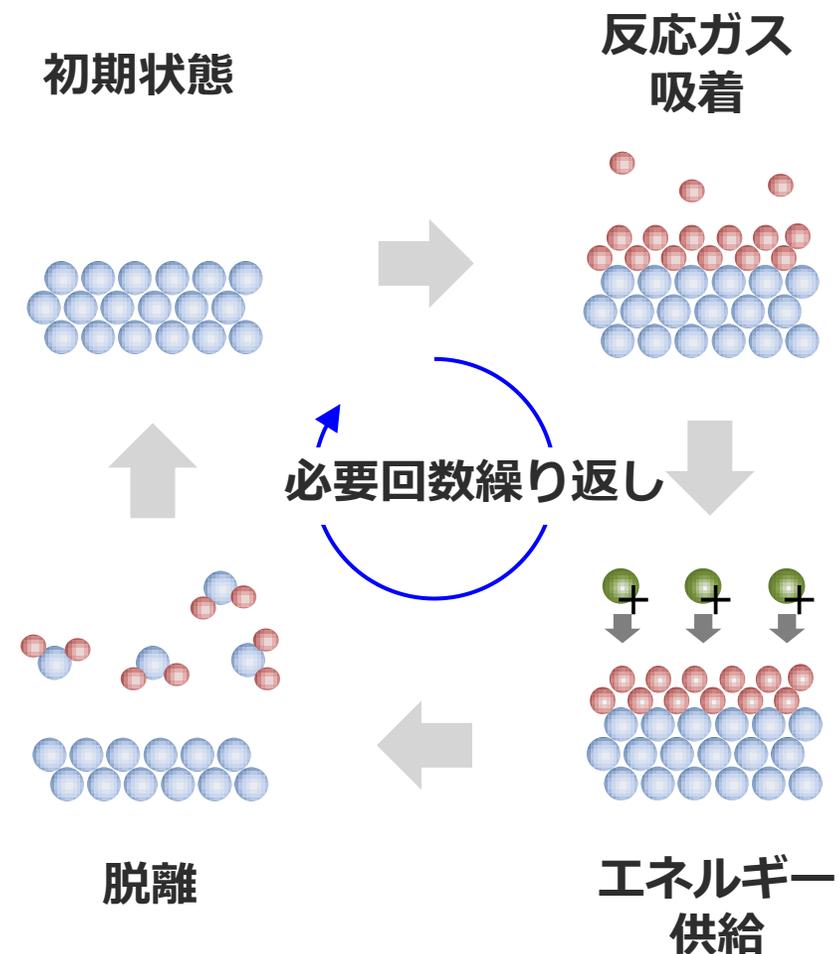
■ 市場ニーズ



■ 当社の取り組みと成果

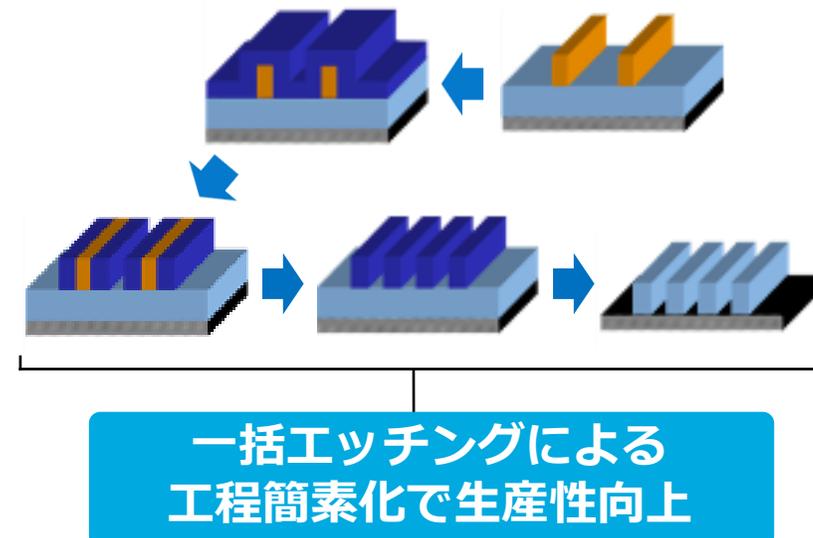
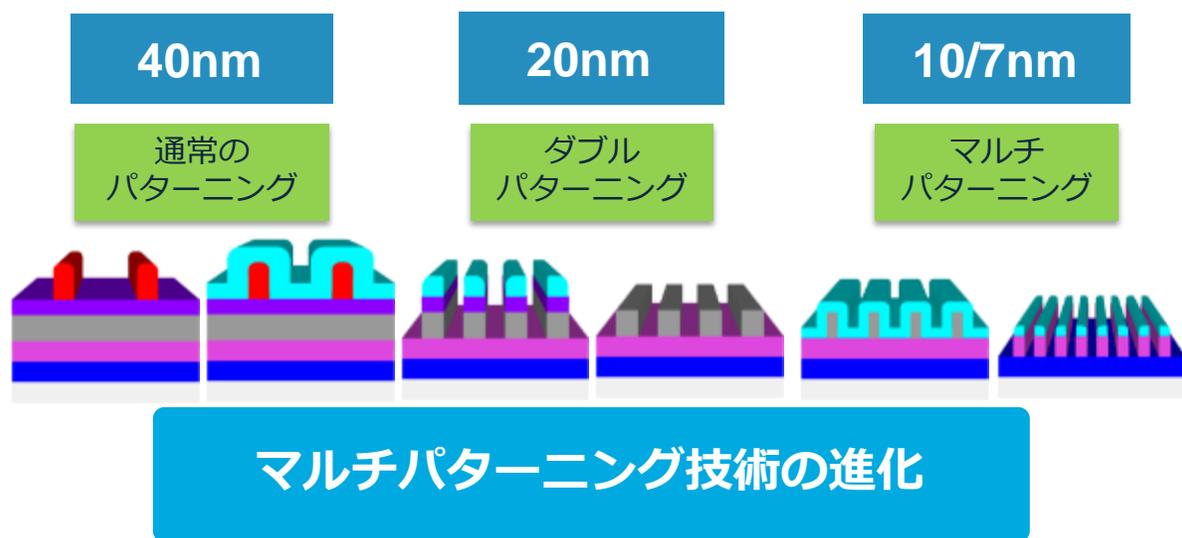
- 電力供給システムの最適化により、高選択比ALEを実現
- ガス供給システムの改善により、生産性が向上

ALE コンセプト



ロジック/DRAM向けパターンニング

■ 市場ニーズ



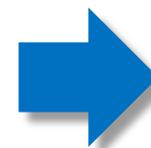
■ 当社の取り組みと成果

- ロジック：酸化膜エッチングの強みを活かして、拡大するパターンニング工程に対応
- DRAM：ロジックでの採用実績と一括化による生産性メリットの実現

サマリー

- ロジックの配線/コンタクト工程での強固なポジション、HARC/パターンニングの市場ニーズを実現する当社の取り組みにより、中期目標（シェア+10ptsによる収益性向上）を達成する

市場シェア	CY2014	CY2015
エッチング装置	26%	19%



CY2019目標
>36%

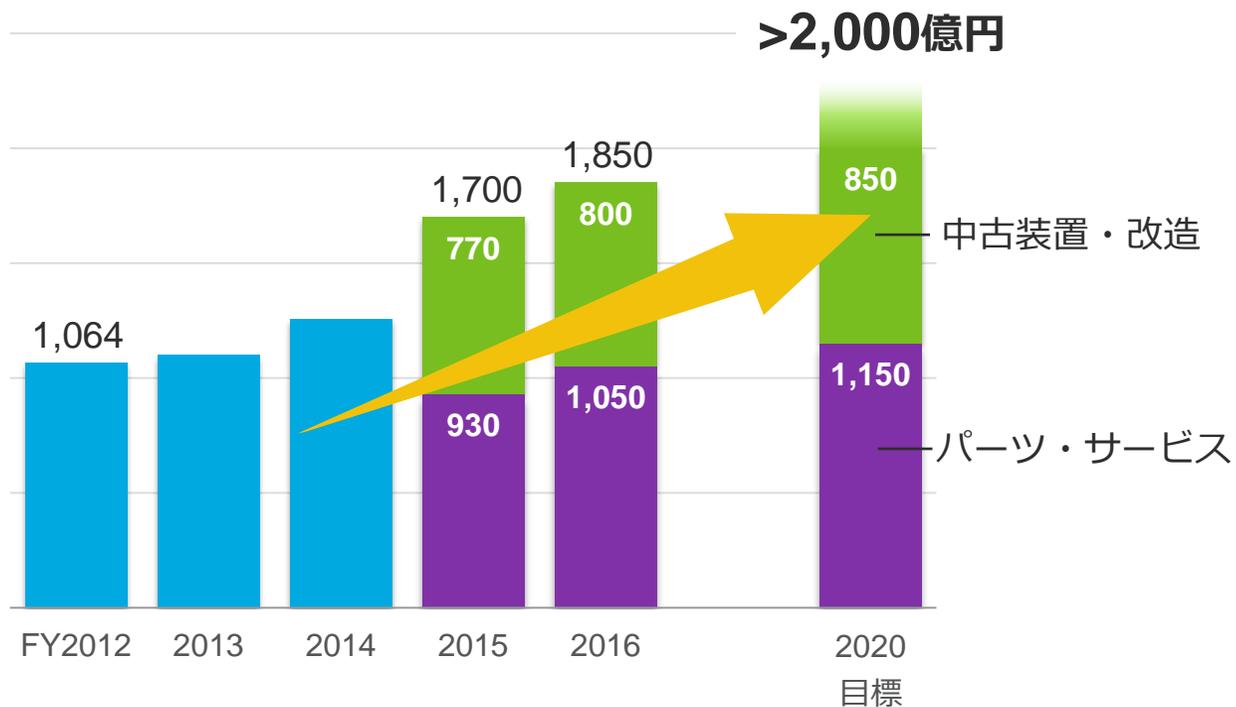
フィールドソリューション 事業戦略

春原 清
常務執行役員 FS BUGM



2016年3月期のハイライトと売上計画

フィールドソリューション売上高



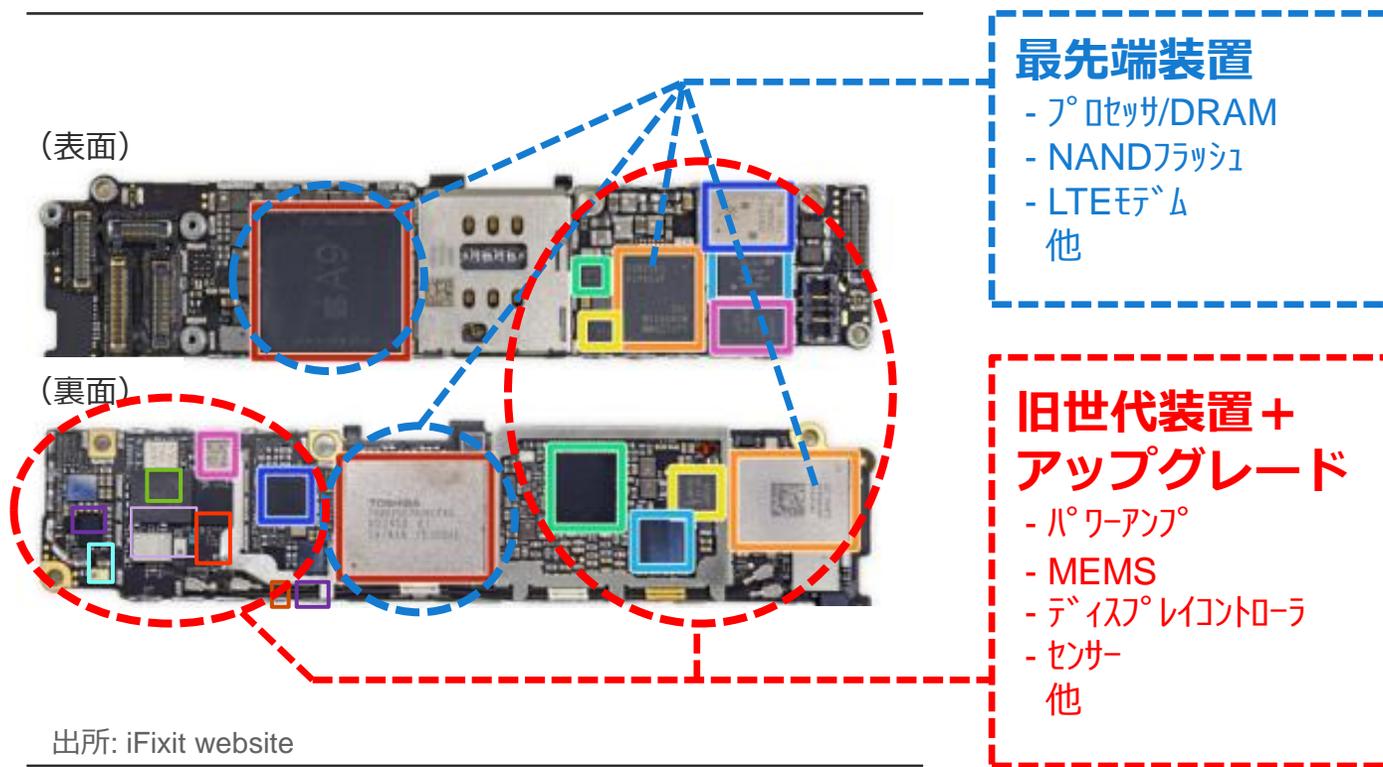
2016年3月期のハイライト

- 前年比150億円の売上拡大
- 再製作装置の提供開始
- 新サービスTELeMetrics™の導入
- リモート接続 50FAB
- 納入済み装置台数59,000台

中古装置/改造およびパーツ/サービスの両セグメントで収益向上

IoTで広がる事業機会

iPhone 6S 搭載チップ



IoTにドライブされる顧客ニーズ

- 中古装置・改造
 - 短納期/低価格
 - 新しいアプリケーション対応
 - ニーズ変化に即したアップグレード提供
- パーツ・サービス
 - 装置の安定稼動
 - ランニングコストの低減
 - 装置のロングライフサポート

最先端技術へのアップグレードが各世代の装置で求められる

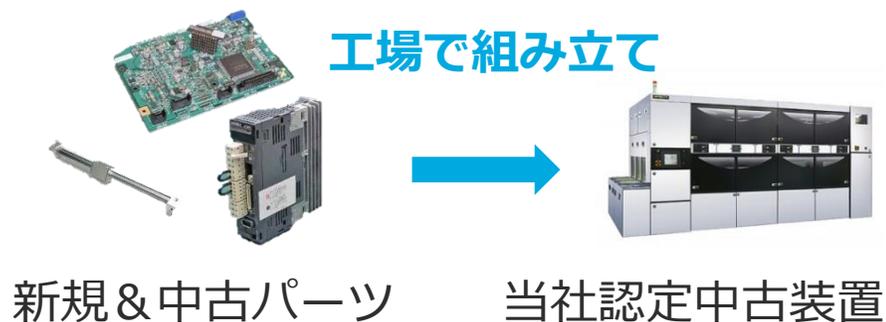
メーカーの強みを活かしたビジネスモデル

中古装置/改造

1. 安定した装置供給体制

■ 再製作装置モデル

従来からの中古装置を調達・改造・転売するビジネスに加え、中古/新規パーツを組み合わせる再製作装置を提供



2. 顧客ニーズに応えるアップグレード

■ 納入済み装置の機能アップおよび延命化

IoTにより多種多様なデバイスニーズが出現、納入済み装置のリユースによる延命が求められる。こうしたニーズに応えるアップグレードを提供



メーカーの強みを活かしたビジネスモデル

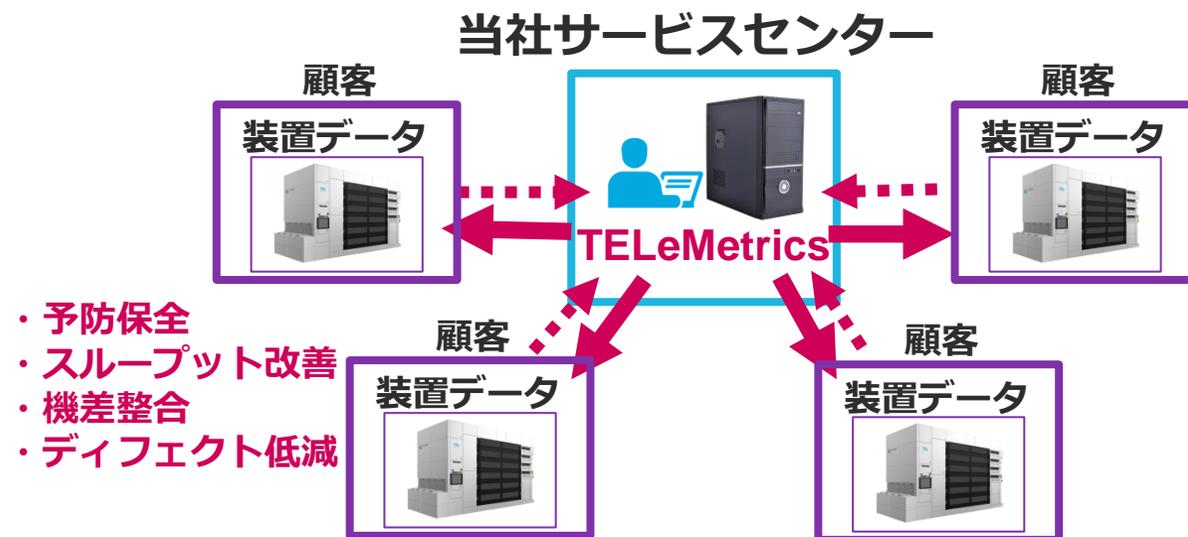
パーツ/サービス

1. TELeMetrics™ サービス

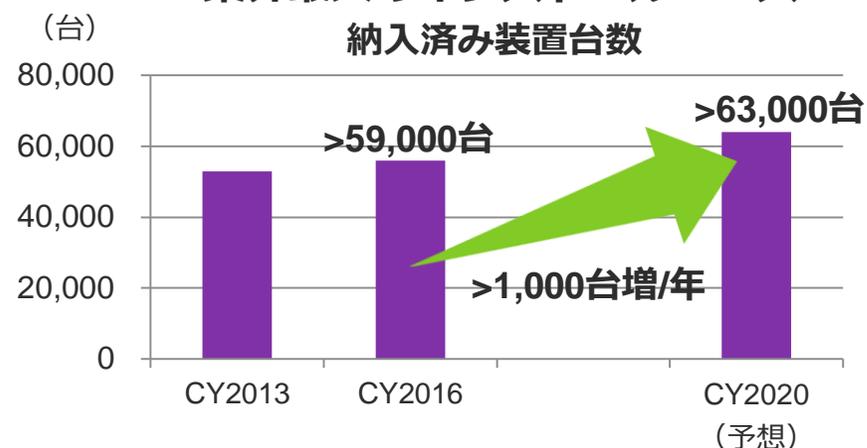
顧客装置の稼働状況をリアルタイムでモニターし、高付加価値サービスを提供する

2. パーツ年間契約によるシェア拡大

納入台数の拡大に加え、サービスパーツ、消耗品、リペアを複合的に組み合わせ、顧客ニーズを満足する契約を提供する



業界最大のインストールベース
納入済み装置台数



サマリー

- IoTで広がる多様な技術ニーズに対して、装置メーカーの強みを活かしたビジネスモデルで事業を推進する
- サービス・パーツ・中古装置・アップグレードなど幅広くビジネスを展開することにより、売上拡大と収益性向上を実現する

FPD 事業戦略

松浦 次彦
執行役員 FPD BUGM



ディスプレイトレンド

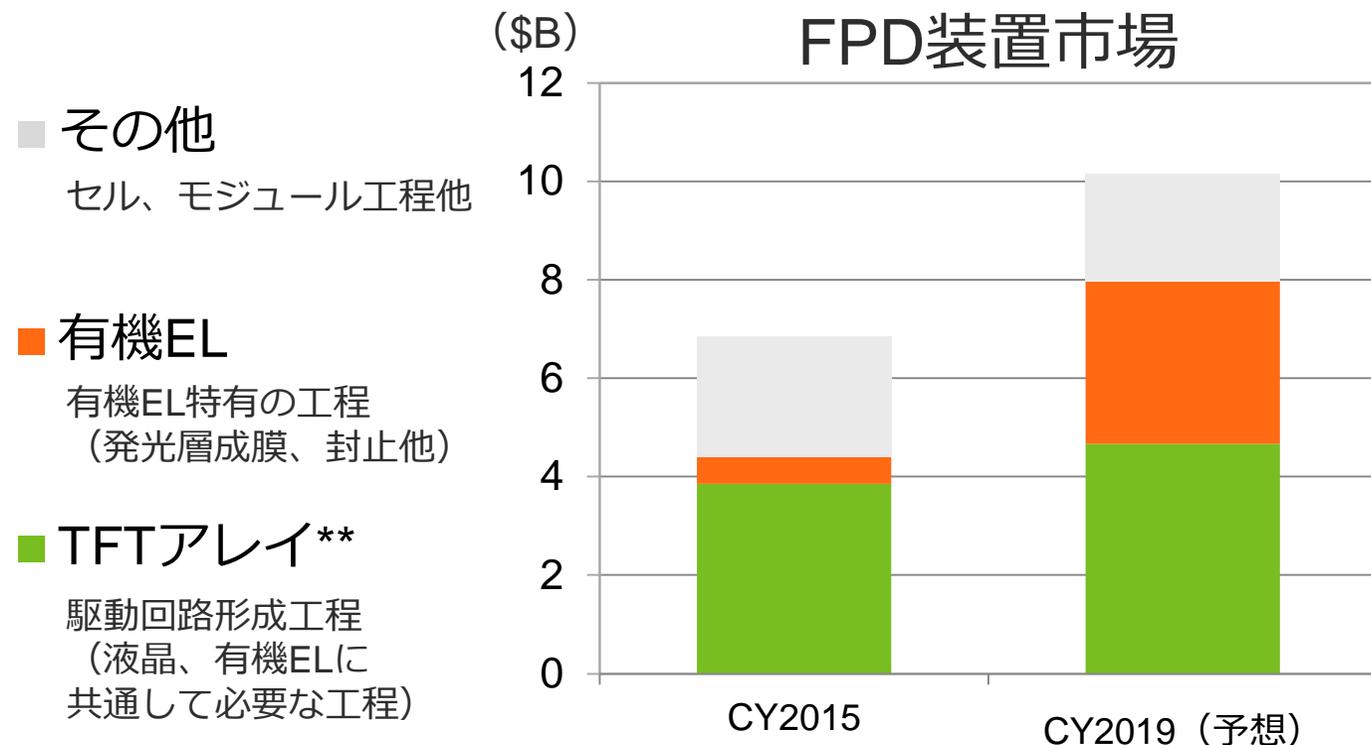
有機ELなど技術変革期 ⇒ 事業機会が拡大

	既存製品	次世代製品
最終製品	<p>ノートブック</p>  <p>モニター</p>  <p>TV</p>  <p>スマートフォン</p>  <p>タブレット</p> 	 <p>有機EL TV* 4K/8K TV</p>  <p>フレキシブル*</p>
ディスプレイ技術	アモルファスシリコン ⇨	低温ポリシリコン、 酸化物半導体、有機EL
要求性能	大画面、低コスト ⇨	高精細、フレキシブル、 大型TV（65インチ以上、8K）

*出所: LG Display website

FPD製造装置市場と中期計画

- 再成長する市場でシェアと収益性を向上
- 2020年3月期目標：売上600億円・営業利益率20%以上
(2016年3月期実績：売上446億円・セグメント利益率*10%)



差別化可能な
先端分野で売上拡大

- ・ インクジェット
有機EL描画装置
- ・ 第10.5世代対応
エッチング装置、
コータ/デベロッパ
- ・ 高性能PICP™***
エッチング装置

出所：IHS Technology, Display Supply Demand Equipment Tracker Data Tables Q1 2016

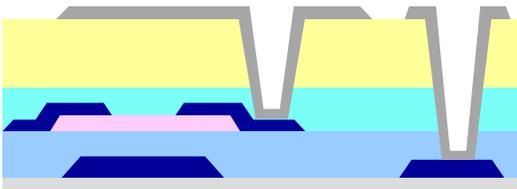
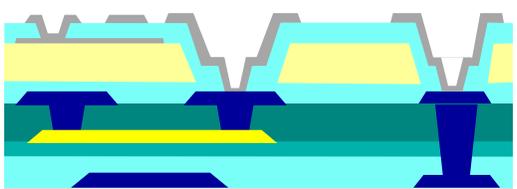
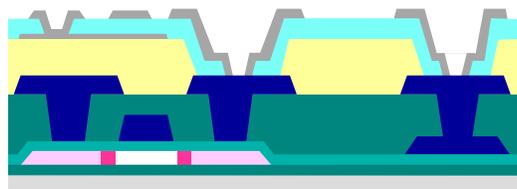
* セグメント利益率は、税前利益率です

** TFTアレイ：ディスプレイを駆動させる側の基板を製造する工程

*** PICP：パネル基板上に極めて均一な高密度プラズマを生成するプラズマソース

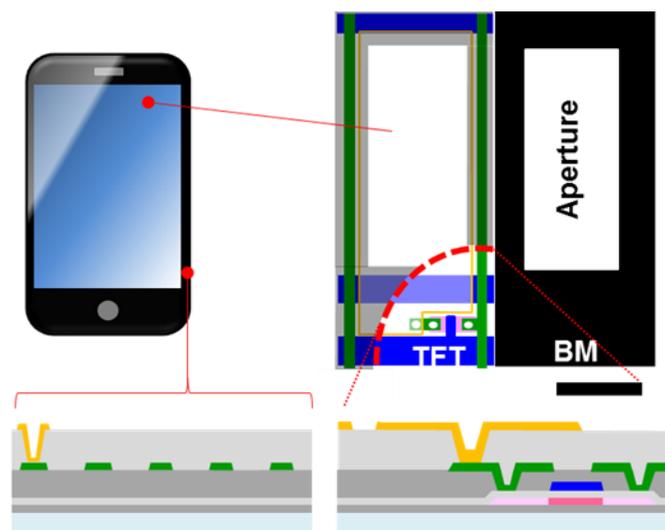
事業機会：酸化物半導体・低温ポリシリコン

液晶・有機ELのエッチング技術の高度化と工程数増加

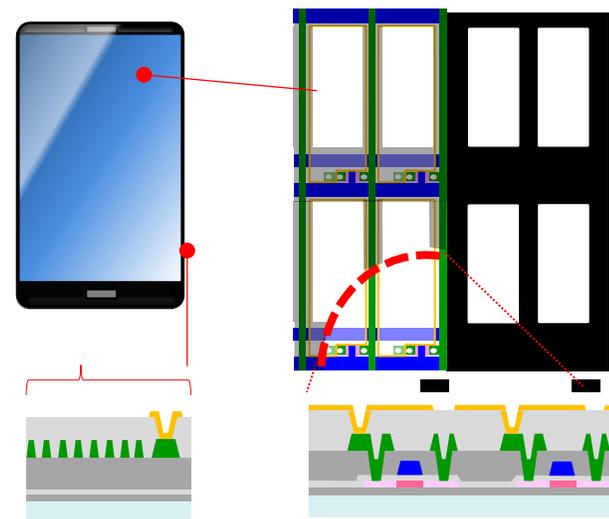
TFTアレイ	アモルファスシリコン (a-Si)	酸化物半導体	低温ポリシリコン
構造図			
アプリケーション	液晶 TV モニター	タブレット 有機EL TV	スマートフォン (液晶、有機EL)
マスク数	5	6 ~ 8	9 ~ 13
ドライエッチング 工程	3 a-Si、SiNx	3 SiO、SiNx	~11 SiO、金属

PICP™ エッチング装置

当社独自の高精度プラズマ技術により、
低温ポリシリコンの液晶/有機ELでシェア拡大



TFTの微細化
コンタクトホール小径化
配線の厚膜/微細化
基板サイズ大型化



PICP™ エッチング装置の特長

エッチング加工精度向上
連続処理時プロセス変動抑制
下地ロス抑制（均一性、選択性）



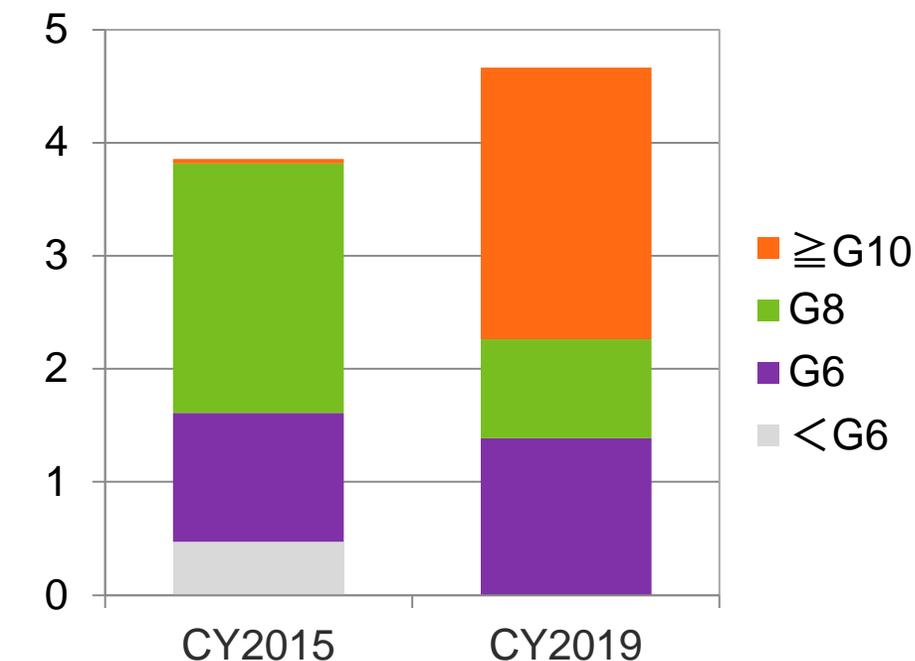
事業機会：大型TV市場の拡大/第10.5世代基板サイズ

第10世代実績と差別化技術（大面積プラズマ制御、エア浮上コータ）で急拡大する第10.5世代市場で高シェア獲得を見込む

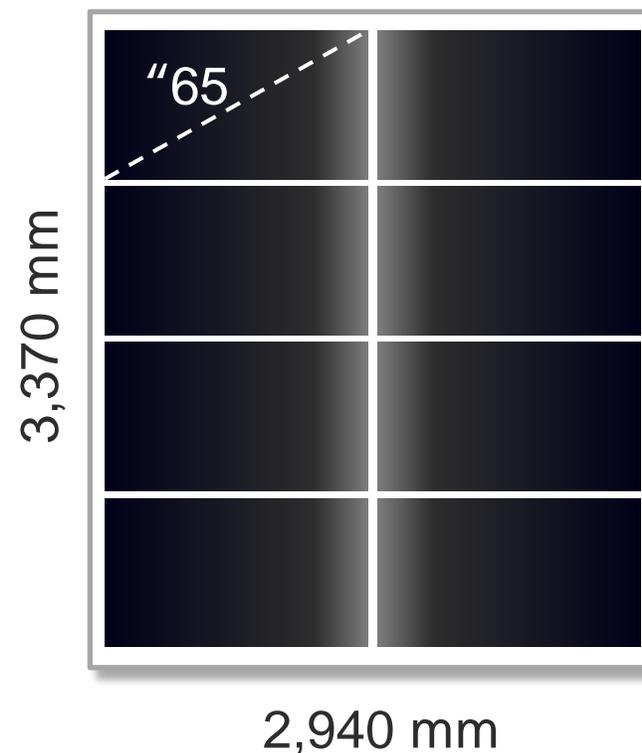
TFTアレイ工程向け装置市場

65インチ TVパネル 8面取りが可能

(\$B) (基盤サイズ別)



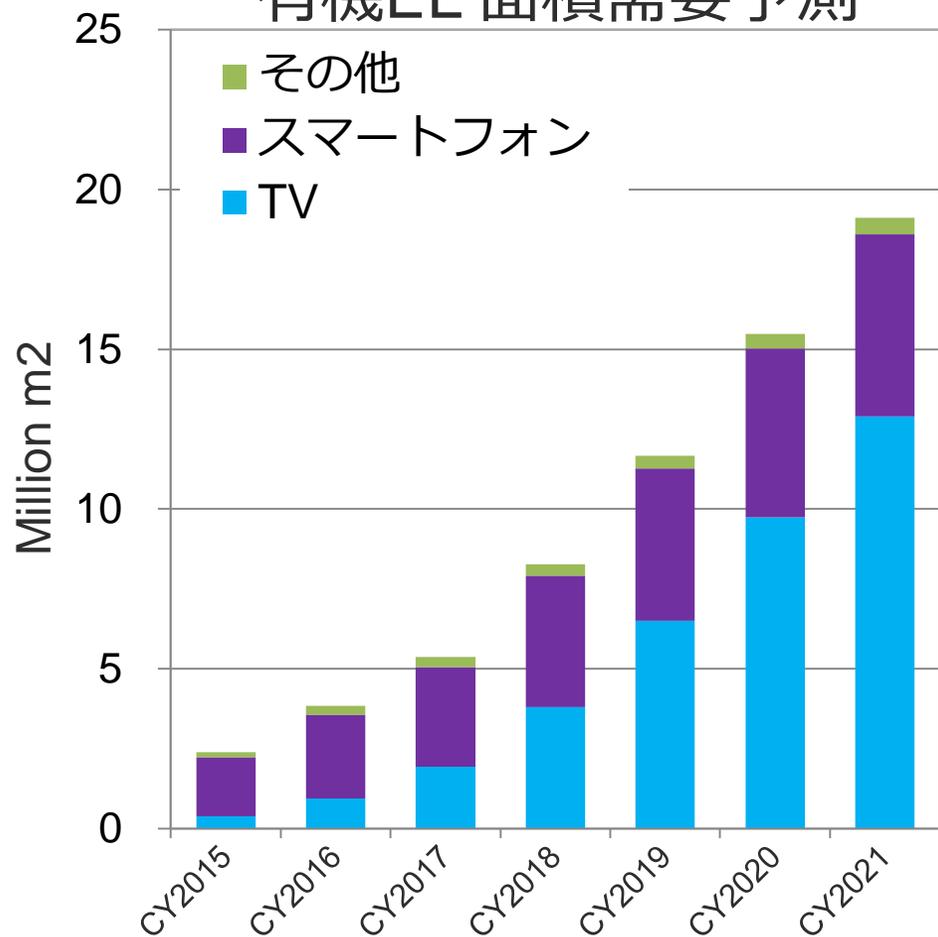
出所：IHS Technology, Display Supply Demand Equipment Tracker Data Tables Q1 2016



事業機会：有機EL TV市場の拡大

2018年以降の立ち上がりに向けてインクジェット描画装置を市場投入

有機EL 面積需要予測



出所: IHS Technology, Display Long Term Demand Forecast Tracker 1Q16

有機ELパネル製造用
インクジェット描画装置 *Elius*TM2500



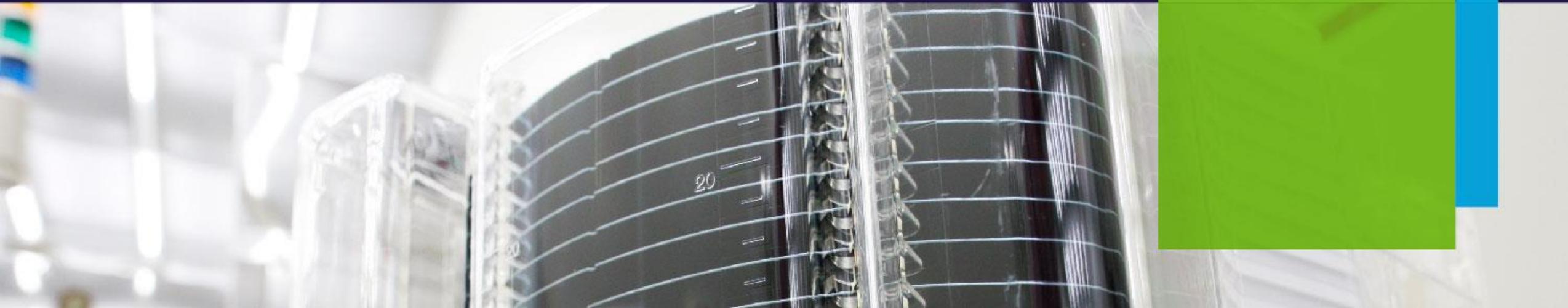
蒸着方式に比べ圧倒的な材料使用効率

サマリー

- **再成長する市場でシェアと収益性を向上**
2020年3月期目標：売上600億円・営業利益率20%以上
- **最先端の製造プロセスにおいて技術的な優位性を持つ分野に注力**
 - 高性能PICPエッチング装置
 - 第10.5世代基板対応 エッチング装置、コータ/デベロッパ
 - 有機EL TV向けインクジェット描画装置

中期計画進捗報告（Financialの観点から）

堀 哲朗
代表取締役、専務執行役員、コーポレート管理本部長



財務モデル

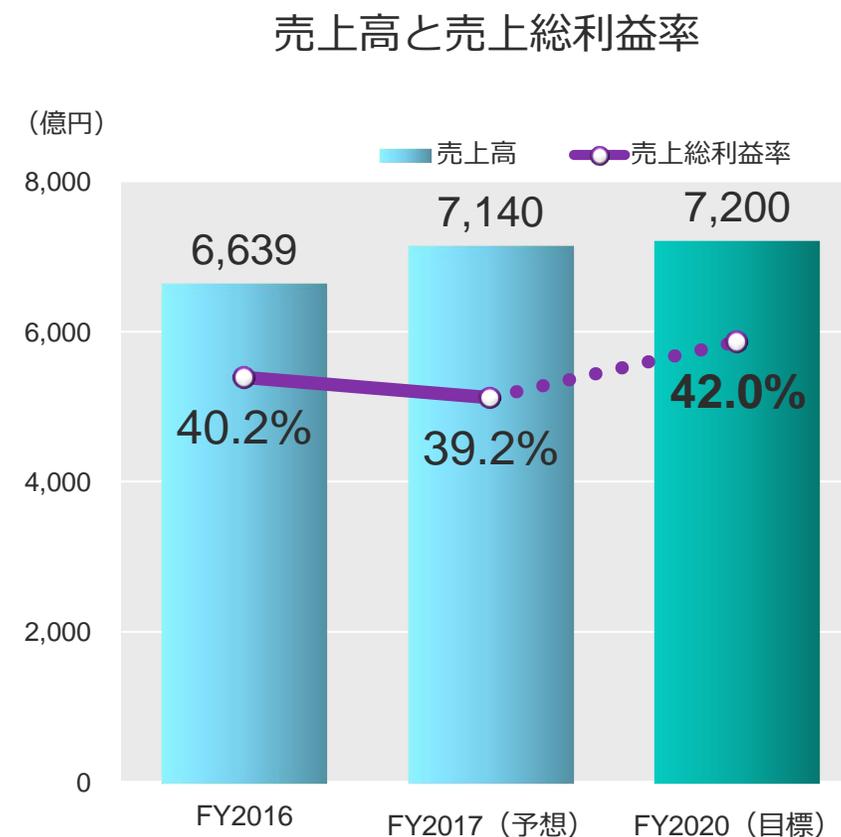
(億円)

	2016年3月期 (実績)	2017年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	
	WFE \$31B	WFE \$31B	WFE \$30B	WFE \$37B
売上高	6,639	7,140	7,200	9,000
SPE	6,130	6,650	6,600	8,400
FPD	446	490	600	600
売上総利益	2,672	2,800	3,050	3,950
下段：売上総利益率	40.2%	39.2%	42%	44%
販管費	1,504	1,560	1,600	1,700
下段：売上高販管費比率	22.6%	21.8%	22%	19%
営業利益	1,167	1,240	1,450	2,250
下段：営業利益率	17.6%	17.4%	20%	25%
当期純利益	778	850	1,000	1,550
ROE	13%	-	15%	20%

財務モデルから見た当社取り組み

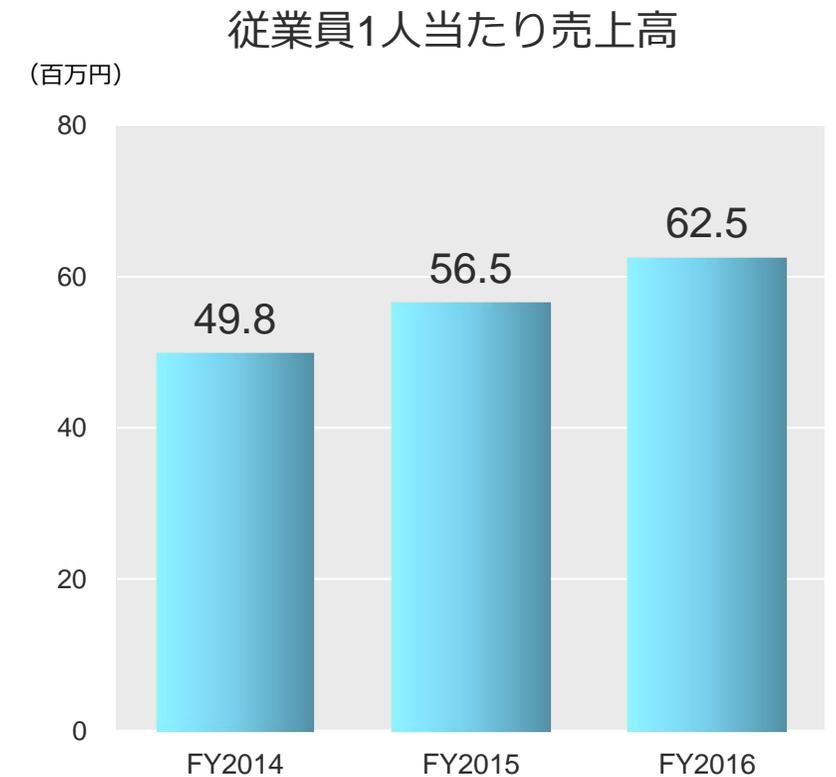
FY2017（予想）と売上7,200億円モデルとの比較

- 課題：売上は同水準にあるが、売上総利益率はFY2020目標に対し、まだ3pts不足
- 対策：
 1. さらに差別化された装置・サービスを市場に供給。高い付加価値を提供し、収益性の向上を図る
 2. 装置性能を早期に担保、品質のさらなる向上により、原価率低減を目指す
 3. 納期短縮により、外注費などの原価を削減



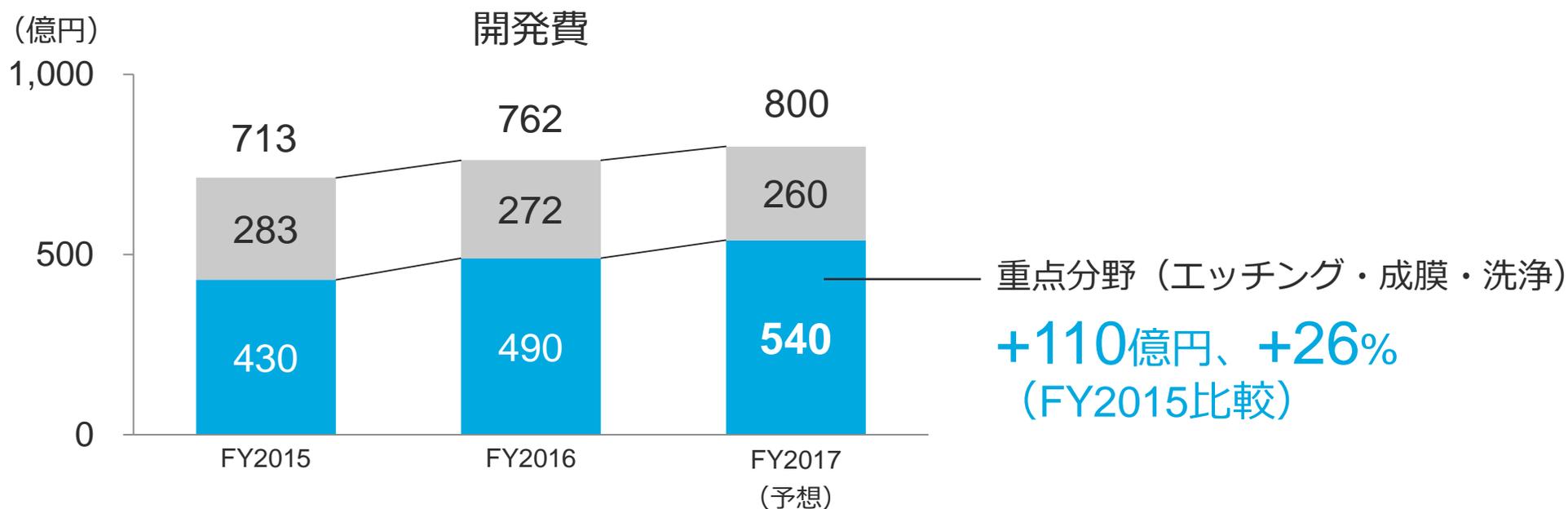
販管費のコントロール

- 進捗：販管費の水準は計画通り
- 今後：
 1. 開発部門の一元化により効率性を追求
 2. 販管費をリバランス、開発費に再配分
 - ITシステムを強化、生産性を向上
 - 売上成長と在庫抑制を両立、省スペース化を推進
 - 人員増以上の売上高拡大をめざす



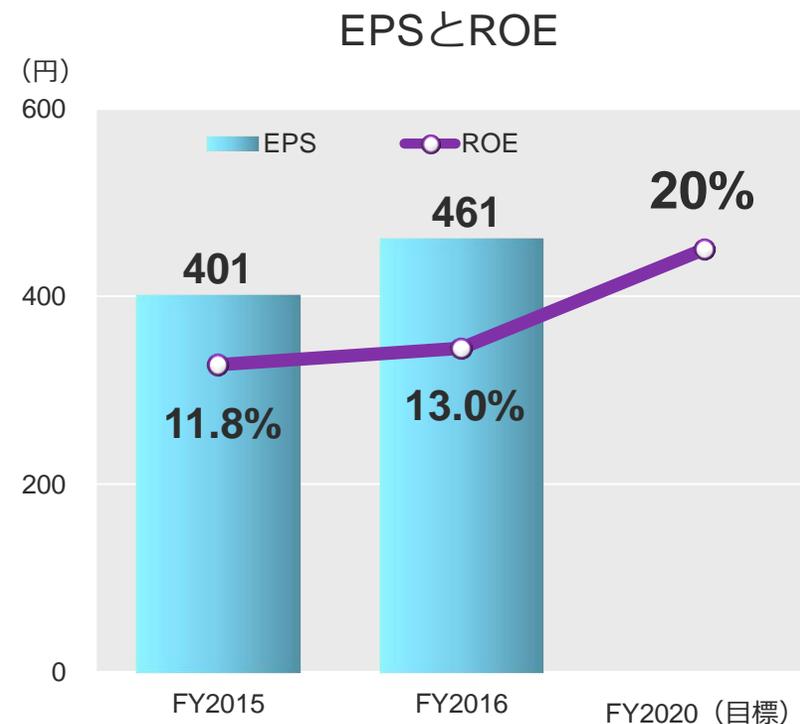
開発の効率化

- 各製品の先端技術を融合するビジネスユニット横軸の開発を強化
- 戦略プロダクトにリソースを集中
 - 重点分野の開発費 540億円（FY2015比較で+110億円、26%増加）



資産・資本効率（売上9,000億円モデル）

- 売上債権回転日数
 - 現状 60日前後 → 適正
- 在庫回転日数
 - 現状 107日 → 目標 85日
- ROE
 - 現状 13% → 目標 20%



ROE = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均自己資本 x 100

サマリー

- FY2020の財務モデル達成に向け進捗
- 利益率目標達成へのカギは、製品競争力のさらなる強化と、品質向上による売上総利益率の拡大
- 開発・オペレーション効率向上を推進

**グローバル水準の収益力を追求し
企業価値のさらなる向上を目指します**

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

TEL™

TOKYO ELECTRON